



Corso Luigi Einaudi, 55 - Torino

**Appunti universitari**

**Tesi di laurea**

**Cartoleria e cancelleria**

**Stampa file e fotocopie**

**Print on demand**

**Rilegature**

NUMERO: 1251

DATA: 27/10/2014

# **A P P U N T I**

STUDENTE: Arcangeli

MATERIA: Sistemi e Tecnologie Elettroniche

Prof. Bonani

Il presente lavoro nasce dall'impegno dell'autore ed è distribuito in accordo con il Centro Appunti.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, copia totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente volume, ivi inclusa la memorizzazione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque supporto magnetico o cartaceo, piattaforma tecnologica o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell'autore.

**ATTENZIONE: QUESTI APPUNTI SONO FATTI DA STUDENTIE NON SONO STATI VISIONATI DAL DOCENTE.  
IL NOME DEL PROFESSORE, SERVE SOLO PER IDENTIFICARE IL CORSO.**

**Corso di**  
**Sistemi e Tecnologie Elettroniche**

**Prof. Fabrizio Bonani**  
**Anno Accademico 2013-2014**

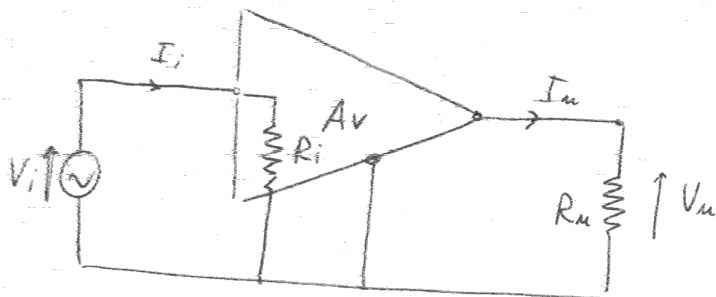
**Studente: Marco Arcangeli**

555: Vale in mente che un aumento di tensione lo fa anche un trasformatore, ma l'amplificatore oltre a qst deve avere un aumento di potenza, cosa che al trasformatore "non basta" ( $V_2 I_2 = V_1 I_1$ )

Quindi il trasformatore non può essere considerato come un amplificatore perché qst ultimo fa sì che:  $V_2 I_2 \gg V_1 I_1$  cioè INCREMENTA LA POTENZA (oltre che la tensione).

→ La potenza aggiuntiva viene fornita dall'esterno attraverso l'alimentazione. Cioè la potenza dissipata dall'amplificatore viene usata dall'amplificatore stesso per amplificare il segnale d'ingresso.

### GUADAGNO DI POTENZA IN dB



$$P_i = V_i \cdot I_i$$

$$P_u = V_u \cdot I_u$$

Per un guadagno di potenza  $K_p$

$$K_p = \frac{P_u}{P_i} = \frac{V_u \cdot I_u}{V_i \cdot I_i}$$

$$|G_p|_{dB} = K_p(dB) = 10 \log_{10} |P_u/P_i|$$

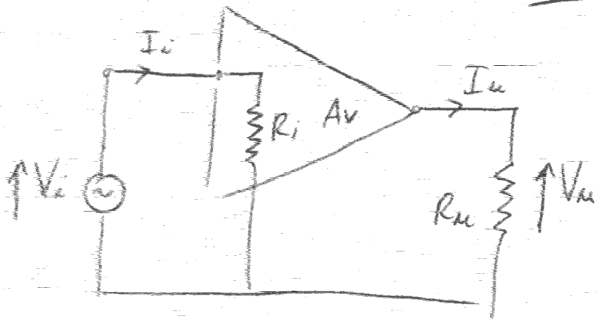
GUADAGNO IN TERMINI DI POTENZE IN dB

↓ trasf. = lineari

$$K_p = \frac{P_u}{P_i} = 10^{\frac{K_p(dB)}{10}} = 10^{\frac{K_p(dB)}{20}}$$

GUADAGNO IN TERMINI DI POTENZE LINEARI

## → AMPLIFICATORE DI CORRENTE (I → V)



$$I_i = \frac{V_i}{R_i}$$

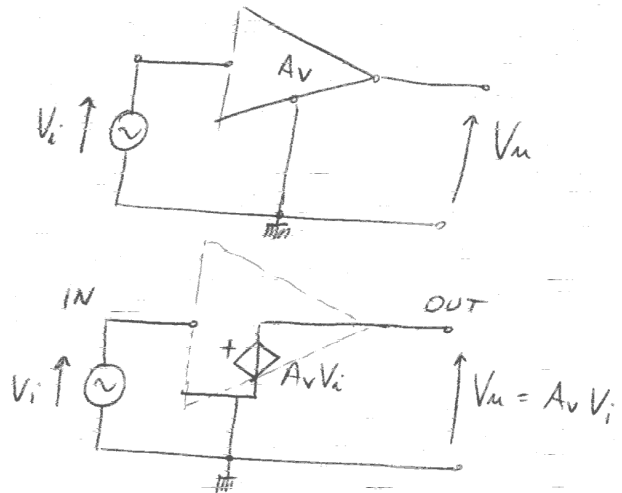
$$I_u = \frac{V_u}{R_u}$$

$$\frac{P_u}{P_i} = \left( \frac{V_u}{V_i} \right)^2 \frac{R_i}{R_u}$$

→ si nota subito che è importante il valore della  $R_i$ . Infatti per un buon guadagno deve essere grande e quindi la  $I_i$  conseguentemente deve essere piccola. Più piccola è stata la  $I_i$  (d'ingresso) tanto maggiore sarà l'amplificazione della  $I_u$  (d'uscita).

## → MODELLO DI AMPLIFICATORE IDEALE

Posso rappresentarlo come un doppio bipolo (2-porte) contenente un generatore pilotato (in corrente o in tensione, dipende dal tipo dell'amplificatore ovrano).

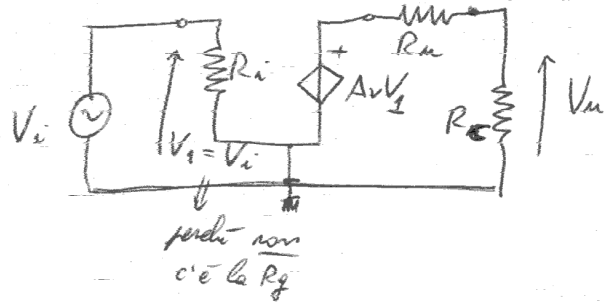


- Essendo, come detto, ideale i circuiti non hanno elementi resistivi e quindi non presentano perdite, sia in ingresso che in uscita. ( $R_i \rightarrow \infty$ )  
↓  
c.a.

→ EFFETTO DI  $R_u$  (senza  $R_g$ )

Per la presenza di  $R_u$  tra il generatore di tensione pilotato e il carico  $R_c$  si ~~crea~~ una partizione. Cambia ovviamente anche il valore di  $V_1$  che sarà uguale al generatore d'ingresso  $V_i$ .

$$V_u = A_v V_1 \frac{R_c}{R_c + R_u} \quad (\text{P.T.})$$



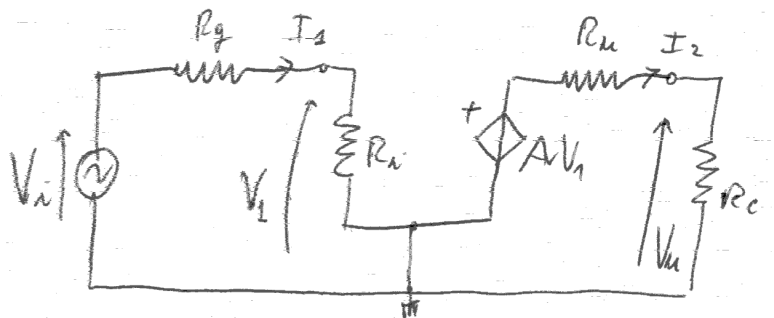
$$\frac{V_u}{V_i} = \frac{A_v R_c}{R_c + R_u}$$

FAITORE DI PERDITA  
SENSIBILE AL CARICO  $R_c$

(Voglio la  $R_u$  più bassa possibile).

→ EFFETTO COMBINATO DI  $R_i$  ed  $R_u$

Si unisce le due partizioni in serie prima con  $R_u$  e senza  $R_g$  e con  $R_i$  e senza  $R_u$ .



La funzione di trasferimento dovrà tenere conto di tutte e due le partizioni dunque:

1° partizione

$$V_1 = V_i \frac{R_i}{R_i + R_g}$$

$$V_i = V_1 \frac{R_i + R_g}{R_i}$$

2° partizione

$$V_u = A_v V_1 \frac{R_c}{R_c + R_u}$$

Nota: Si possa utilizzare le 2 maglie indipendentemente.

Da cui avremo che:

$$\frac{V_u}{V_i} = A_v \left[ \frac{R_c}{R_c + R_u} \right] \left[ \frac{R_i}{R_i + R_g} \right]$$

Da cui deriva che per avere il caso più ideale possibile gli ampl. di tens. dovranno essere costruiti d. composizione

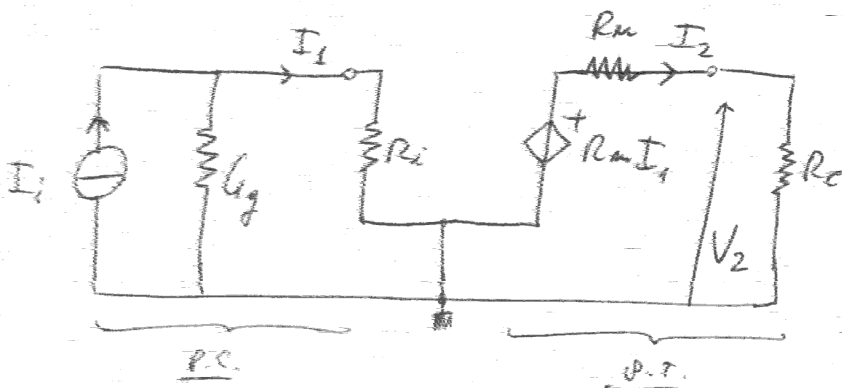
$$\left\{ \begin{array}{l} R_i \rightarrow \infty \\ R_u = \emptyset \end{array} \right.$$

Quindi i parametri per costruire un buon amplificatore di corrente

$I \rightarrow I$  sono:

$$\underline{R_i = \phi} \quad \text{e} \quad \underline{G_u = \phi} \Rightarrow \underline{R_u \rightarrow \infty} \quad (G_u = \frac{1}{R_u})$$

→ AMPLIFICATORE DI TRANSRESISTENZA ( $I \rightarrow V$ ) -  $R_m$



$$I_2 = I_i \frac{G_i}{G_i + G_g} = I_i \frac{R_g}{R_i + R_g} \quad \text{ma per } I_1 \approx I_i \quad (R_i = 0)$$

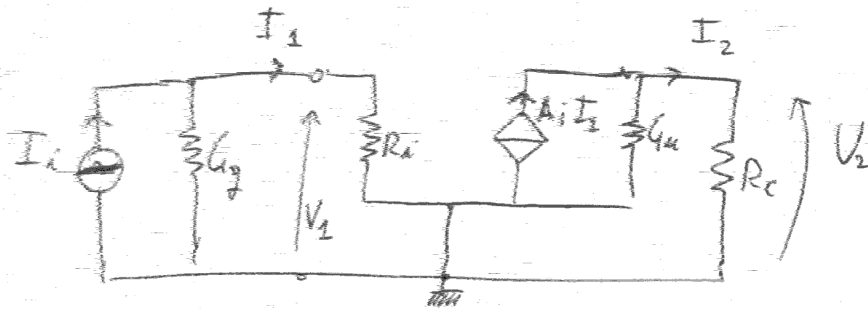
$$V_2 = R_m I_2 \frac{R_c}{R_c + R_u} \quad \text{ma per } V_2 \approx R_m I_1 \quad (R_u = \phi)$$

Quindi i parametri per costruire un buon amplificatore di ~~corrente~~  $I \rightarrow V$  sono:

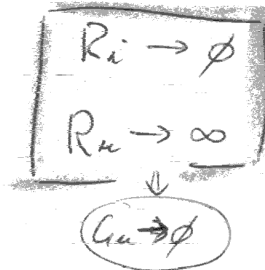
$$\underline{R_i = \phi} \quad \text{e} \quad \underline{R_u = \phi}$$

AMPLIFICATORE DI CORRENTE

$I \rightarrow I$  Adimensionale ( $A_i$ )

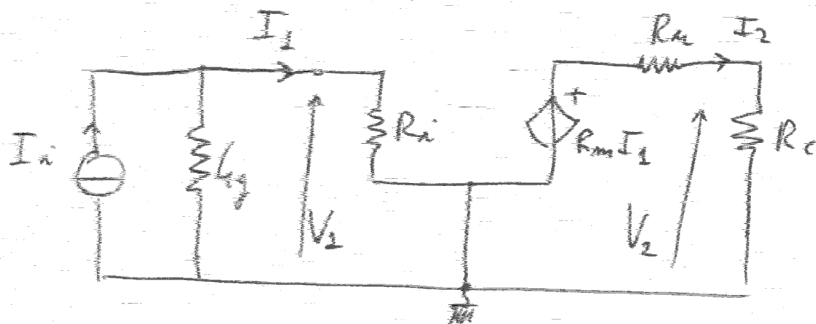


IDEALMENTE

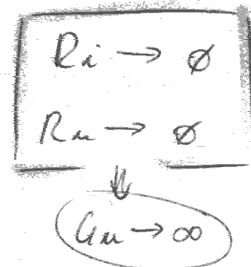


AMPLIFICATORE DI TRANSRESISTENZA

$I \rightarrow V$  Dimensionale ( $R_m - [\Omega]$ )

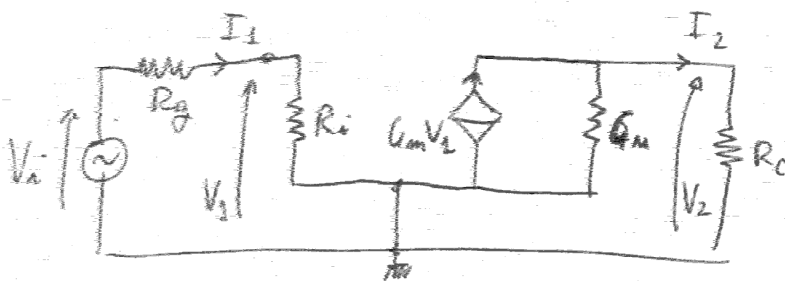


IDEALMENTE

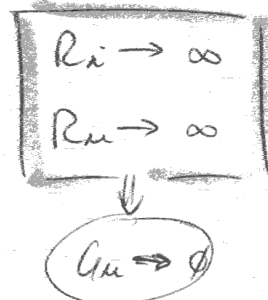


AMPLIFICATORE DI TRANSCONDUZZANZA

$V \rightarrow I$  Dimensionale ( $G_m - [\frac{1}{\Omega} = \Omega^{-1}]$ )

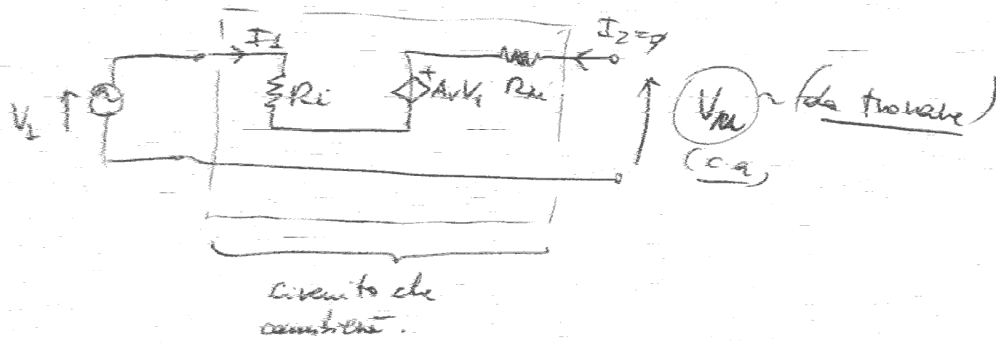


IDEALMENTE

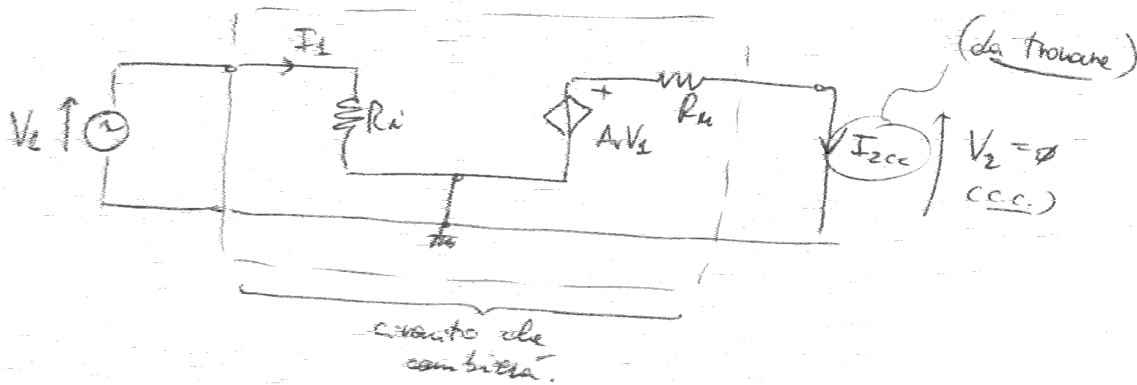




- Il 1° punto del pto 2) è lo stesso circuito e  $V_i$  qd di allora fatto prima per calcolare  $I_1$  solo da adesso dovremo calcolare  $V_u$



- Il 2° pto invece avrà un circuito diverso perché dovremo calcolarci la  $I_{2cc}$

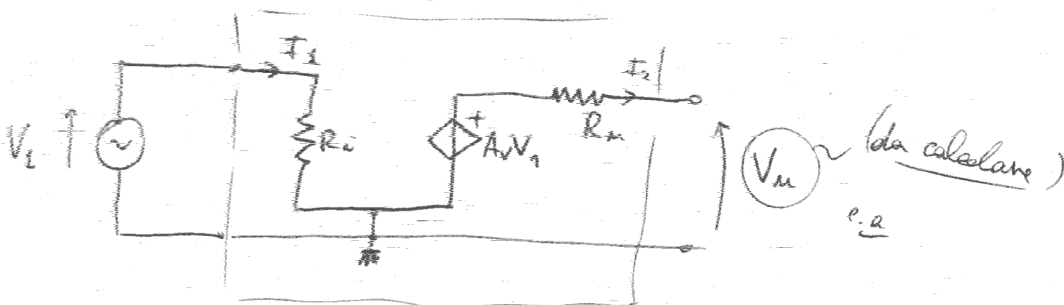


•  $A_v$  con la funzione di trasferimento

- 1) Applicare  $V_i$  all'ingresso
- 2) Calcolare  $V_u$

$$A_v = \frac{V_u}{V_i}$$

- Il circuito ora viene è lo stesso del 1° caso della resistenza d'ingresso solo da adesso mi calcolerò  $V_u$  ( $\rightarrow$  come il 1° pto del pto 2)



053: Fino ad ora abbiamo studiato il comportamento degli amplificatori in "maniera statica", cioè non preoccupandoci con quale frequenza entra nell'amplificatore il segnale d'ingresso -

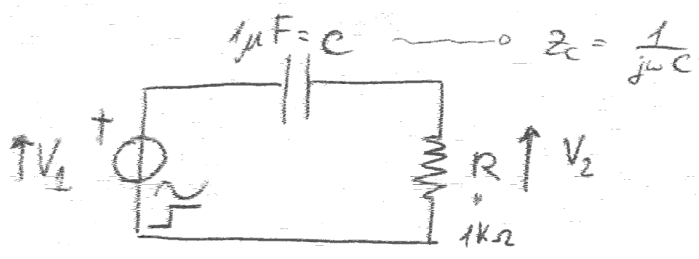
Ma da ora è la freq. d'ingresso del segnale, diverso sarà il comportamento degli amplificatori (cioè la loro "risposta").

→ Nelle prox slide ci occuperemo della risposta in frequenza degli amplificatori.

→ CELLA DEL 1° ORDINE: PASSA-ALTO

Da come si intuisce dal nome qst farà passare le componenti ad alta frequenza del segnale e filtrerà le bass. (Larghezza la continua).

Risultante avendo:



→ RISPOSTA IN FREQUENZA

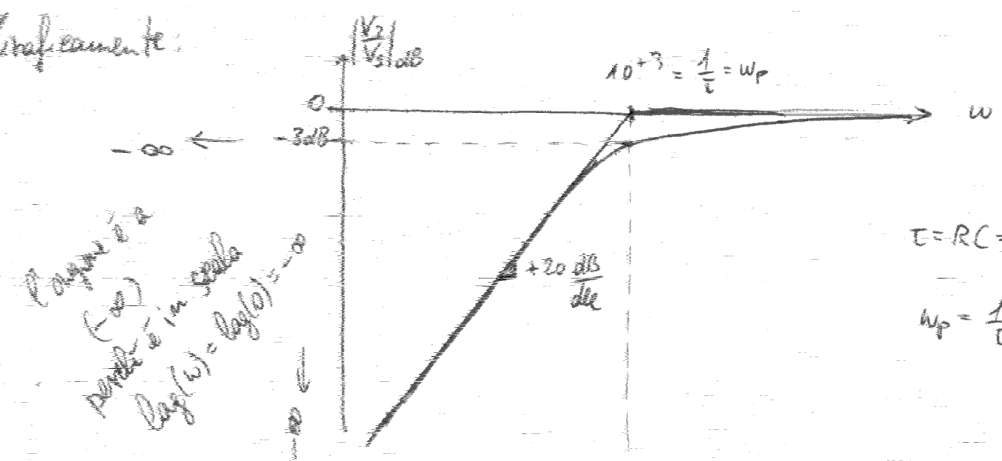
$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{sRC}{sRC + 1} \Rightarrow \text{dove } \tau = RC \text{ (cioè la resistenza equivalente vista dall'elemento reattivo (in qst caso il condensatore) quando il generatore } V_1 \text{ è spento, moltiplicato per il valore del condensatore).}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{s\tau}{s\tau + 1}$$

FUNZIONE TRASF. DELLA CELLA PASSA-ALTO

Non guardiamo solo all'origine (come si vede dal numeratore) e un polo a  $\omega_p = \frac{1}{\tau}$  come si vede dal denominatore →  $\tau \left( s + \frac{1}{\tau} \right)$

Graficamente:



$$\tau = RC = 1k\Omega \cdot 1\mu F = 10^{-3} \text{ [sec]}$$

$$\omega_p = \frac{1}{\tau} = 10^3 \left[ \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \right]$$

possiamo verificare il grafico mediante l'analisi asintotica.

(@  $\omega = 0$ ) →  $|Z_c| = \frac{1}{j\omega C} \rightarrow \infty$  il condensatore si comporterà come un circuito aperto. Il generatore non fornisce corrente alla R e di conseguenza  $V_2 = 0$

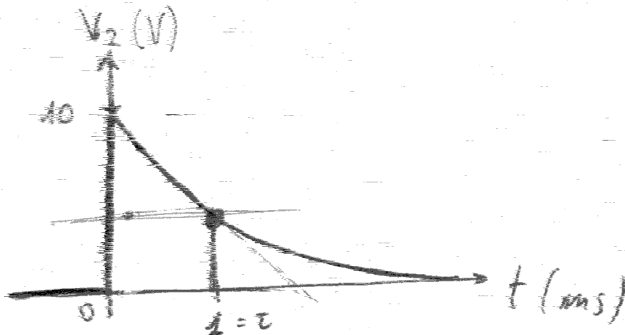
(@  $\omega \rightarrow \infty$ ) →  $|Z_c| = \frac{1}{j\omega C} = 0$  il condensatore si comporta come un corto circuito e pertanto  $V_2 = V_1$

$$\tau = RC = 1k\Omega \cdot 1\mu F = 10^{-3} s = 1 ms$$

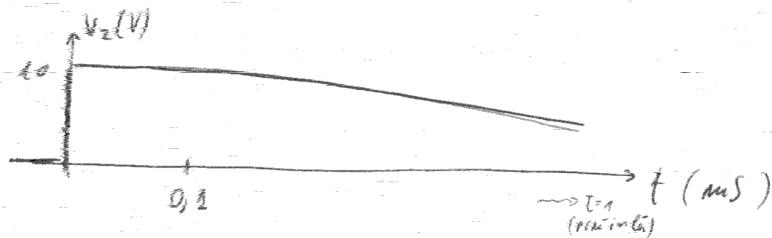
$$V_2(t) = 10e^{-t/\tau} = 10e^{-10^3 t}$$

infatti: &  $t=0 \rightarrow V_2(0)=10$   
&  $t \rightarrow \infty \rightarrow V_2(\infty)=0$

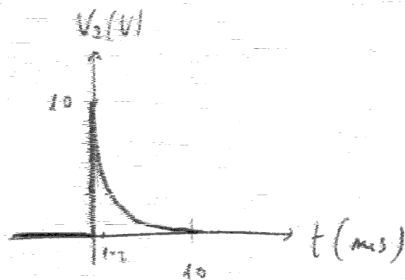
Grafizziamo:



Nota: Bisogna stare attenti alle scale che si usa nel tempo, perché se si usa una scala troppo grande c'è il rischio di vedere l'andamento esponenziale decrescente come una costante.



Viceversa se si usa una scala troppo piccola allora il grafico assomiglia ad un impulso.



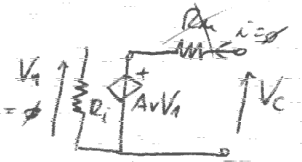
otteniamo  $R_u = \phi$  e quindi rimane solo la  $R_i$ .

Pertanto  $Z = R_i C \rightarrow \omega_p = \frac{1}{Z} = \frac{1}{R_i C}$

Ora all'uscita del nostro amplificatore avremo un'impedenza

$A_v = \frac{V_c}{V_i}$  fattore di amplificazione dell'amplificatore.

Non c'è un carico all'uscita quindi essendo in c.a.  $\rightarrow R_u = \phi$  e di conseguenza  $V_c = A_v V_i$ , da cui:



$A_v = \frac{V_c}{V_i}$  come ci aspettavamo.

Il fattore di guadagno totale sarà dato da:

$A_{TOT} = \frac{V_c}{V_g} = \frac{V_c}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_g} = A_v \cdot A_s = A_{TOT} = \frac{A_v ST}{ST+1}$

funzione trasferimento amplificatore con cella P.A. in ingresso

quest "trucco" mi garantisce l'uguaglianza delle equazioni a allo stesso tempo:

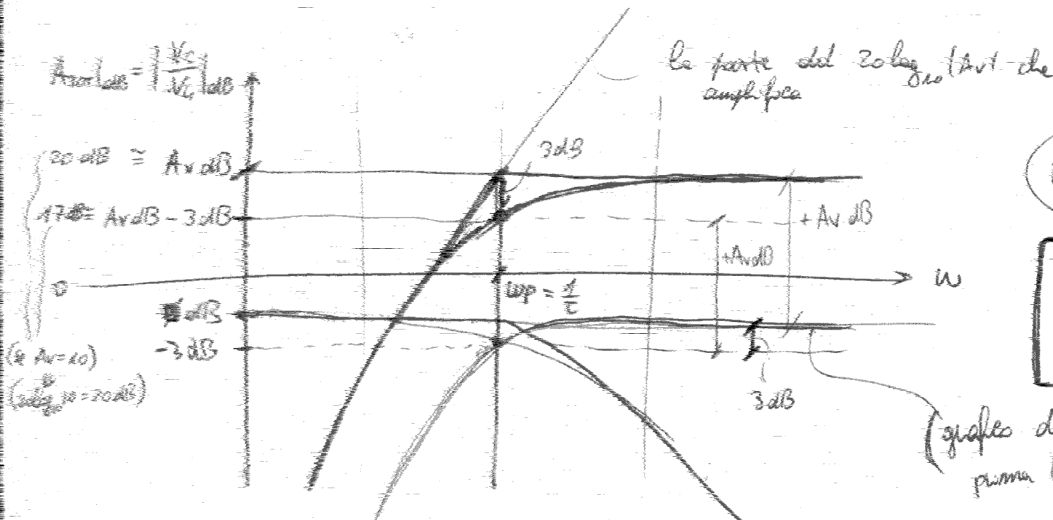
$\frac{V_c}{V_i} = A_v$  e  $\frac{V_i}{V_g} = A_s$   
 fattori di guadagno dell'amplificatore e funzione trasf.

$A_{TOT}(\omega \rightarrow 0) = \frac{V_c}{V_g} = \frac{A_v V_i}{V_i} = A_v @ \omega \rightarrow 0$

(quest perché il condensatore C @  $\omega \rightarrow 0$  è un c.a. o quindi  $V_i = V_g$ )

Per la proprietà dei logaritmi le moltiplicazioni si sommano ed otteniamo:

$A_{TOT} dB = 20 \log_{10} |A_v| + 20 \log_{10} \left| \frac{V_i}{V_g} \right| = \left| \frac{V_c}{V_g} \right| dB$



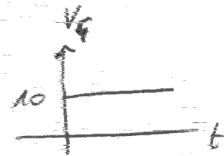
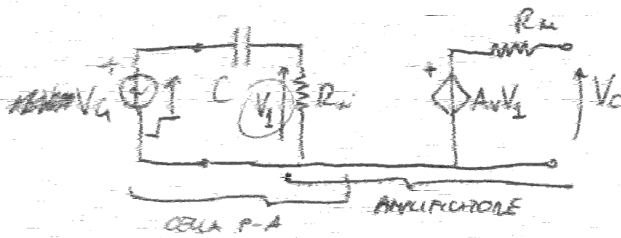
Dove  $A_v dB = 20 \log_{10} |A_v|$

Il grafico aumenterà ogni volta di  $A_v$  dB. Per esempio se  $A_v = 10$   $20 \log_{10} 10 = 20$  dB.

(grafico della cella P.A. vista prima (in freq. angolare))

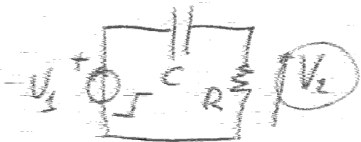
→ ANALISI DEL CIRCUITO

La  $V_1$  del circuito: ~~10000~~



$V_c = \begin{cases} 0 & \text{per } t < 0 \\ 10 & \text{per } t > 0 \end{cases}$

corrisponde alla  $V_2$  della cella p-a studiata precedentemente senza l'amplificatore:



Prediamo quindi il risultato di  $V_2$  che all'anno calcolato e ponendolo uguale a  $V_c$  in qst nuovo circuito con l'ampl. Per cui ingresso abbiamo la cella p-a.

$@ t=0 \rightarrow c.c. \rightarrow V_1 = V_c = 10$  (come si può anche vedere sostituendo  $t=0$  all'equazione di  $V_2$ )  
 $@ t \rightarrow \infty \rightarrow c.c.a \rightarrow V_2 = 0$

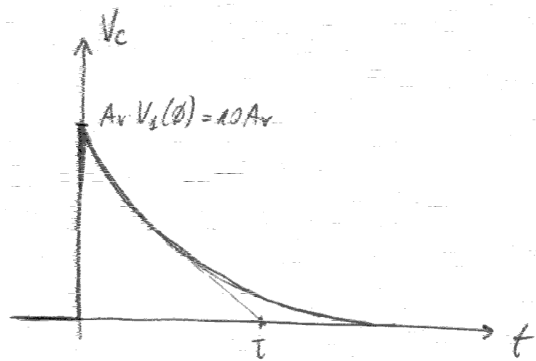
In qst caso non c'è un carico in uscita per cui essendo un c.a. la  $i=0$  e la  $R_u=0$ . Di conseguenza

$$V_c = A_v V_2$$

$$V_c = A_v \cdot V_1 = A_v \cdot 10 e^{-t/\tau}$$

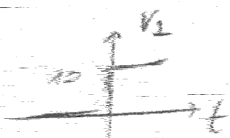
$$@ t=0 \Rightarrow V_c = A_v \cdot 10 = A_v V_1(0)$$

$$@ t \rightarrow \infty \Rightarrow V_c = A_v \cdot 0 = 0$$



→ L'effetto principale di una cella passa-alto è qll del condensatore che blocca la continua del segnale (DC). La continua del segnale d'uscita diventa indipendente da qll del segnale d'ingresso.

→ AL POSTO DEL TEMPO

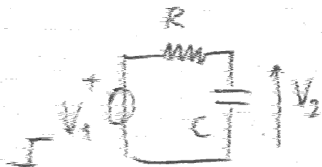


$$V_2 \begin{cases} 0 & \text{per } t < 0 \\ 10V & \text{per } t > 0 \end{cases}$$

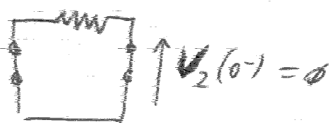
$$V_2(t) = V_A + V_B e^{-t/\tau}$$

Soluzione generale del circuito con il metodo del transitorio.

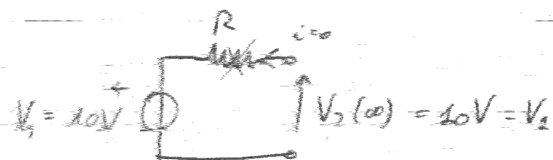
$$V_2(t) = [V_2(0) - V_2(\infty)] e^{-t/\tau} + V_2(\infty)$$



• Per  $(t < 0) \rightarrow (V_2 = 0) \rightarrow (f \rightarrow \infty) \rightarrow (C = c.c.)$



• Per  $(t \rightarrow \infty) \rightarrow (V_2 = 10V) \rightarrow (f \rightarrow 0) \rightarrow (C = c.a.)$



$$\Rightarrow V_2(t) = \left[ -10 e^{-t/\tau} \right] + 10 = \left[ 10(1 - e^{-t/\tau}) \right] = V_2(t)$$

Confrontando con la soluzione generale abbiamo:

$$V_2(t) = V_A + V_B e^{-t/\tau} = 10 - 10 e^{-t/\tau} \begin{cases} V_A = 10 \\ V_B = -10 \end{cases}$$

Andando a asintotizzare:

Per  $(t = 0) \rightarrow V_2(t = 0) = 0 \Rightarrow V_B = -V_A \rightarrow$  ok vera

Per  $(t \rightarrow \infty) \rightarrow (V_2(t \rightarrow \infty) = 10 = V_A = V_1) \rightarrow$  infatti per  $t \rightarrow \infty C \rightarrow c.a.$  e  $V_2 = V_1$

$$\begin{cases} V_2(0) = 0 \\ V_2(\infty) = V_1 = 10V \end{cases}$$

$$A_1(s) = \frac{1}{s\tau + 1} = \frac{1}{sRC + 1}$$

funzione di trasf.  
della cella passa-basso.

In qst caso  $A_v = 100$  ed è il fattore di amplificazione dell'amplificatore.

$$A_{TOT} = A_v A_1 = 100 \frac{1}{sRC + 1}$$

funz. trasf.  
dell'amplificatore

$$A_1(j\omega) = \frac{1}{j\omega RC + 1} = \frac{V_c}{A_v V_1}$$

dove  $V_1$  è il partitore di  
tensione della maglia del generatore.

$$V_1 = V_G \frac{R_i}{R_i + R_G}$$

Da  $A_1(s)$  vediamo che all'anno un  
polo a  $\omega = \frac{1}{\tau}$

Il grafico di  $A_1(j\omega)$  è uguale a qll precedente

$$@ \omega \rightarrow \infty \rightarrow A_1(\infty) = 0$$

$$@ \omega \rightarrow 0 \rightarrow A_1(0) = 1$$

Calcoliamo la funz. di trasf. del circuito prima ipotato.

$$A_{TOT} = \frac{V_c}{V_G}$$

dove:  $V_G$  lo si può calcolare calcolando  $V_1$  tramite un partitore e poi invertendo la formula:

$$V_1 = V_G \frac{R_i}{R_i + R_G} \Rightarrow V_G = V_1 \frac{R_i + R_G}{R_i}$$

$V_c$  lo si calcola con il partitore alla maglia di dx  
e prende  $Z_c = (R_c \parallel \frac{1}{sC}) = \frac{R_c}{sRC + 1}$

$$V_c = 100 V_1 \frac{Z_c}{Z_c + R_u}$$

$$A_{TOT} = 100 V_G \frac{Z_c}{Z_c + R_u} \frac{R_i}{V_1 (R_i + R_G)} = 100 \frac{Z_c}{Z_c + R_u} \frac{R_i}{R_i + R_G} = \text{sostituiamo } Z_c =$$

$$= 100 \left[ \frac{\frac{R_c}{1 + sRC}}{\frac{R_c}{1 + sRC} + R_u} \right] \left[ \frac{R_i}{R_i + R_G} \right] = 100 \frac{R_c}{\frac{R_c + R_u + sRC R_u}{1 + sRC}} \frac{R_i}{R_i + R_G} = \frac{100 R_c}{R_c + R_u + sRC R_u} \frac{R_i}{R_i + R_G} =$$



Calcoliamo  $A_2$  per dimostrare effettivamente il valore di  $T$ .

$A_2 \rightarrow$  funzione trasf. della cella PB.

$$A_2(s) = \frac{V_c}{A_v V_i} \quad \text{dove } V_c = A_v V_i \frac{Z_c}{Z_c + R_u} \quad \text{dove } Z_c = \left( \frac{1}{sC} \parallel R_c \right) = \frac{R_c}{sR_c C + 1}$$

$$\Rightarrow A_2(s) = \frac{Z_c}{Z_c + R_u} = \frac{\frac{R_c}{sR_c C + 1}}{\frac{R_c}{sR_c C + 1} + R_u} = \frac{\frac{R_c}{sR_c C + 1}}{\frac{R_c + sR_c R_u C + R_u}{sR_c C + 1}} = \boxed{\frac{R_c}{R_c + R_u + sR_c R_u C} = A_2(s)}$$

Sostituiamo i valori:

$$A_2(s) = \frac{2000}{2000 + 100 + s(2000)(100)(4.70 \cdot 10^{-12})} = \frac{2000}{2100 + s(0,000094)}$$

$$= \frac{2000}{2100} \cdot \frac{1}{1 + s \left( \frac{0,000094}{2100} \right)}$$

$T = 44 \text{ ms} = 44 \cdot 10^{-3} \text{ s} \rightarrow \text{c.v.d.}$

$\Rightarrow$  In generale quindi:

$$\boxed{A_{TOT} = A_v^m \cdot A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_m}$$

dove:  $A_{TOT}$  è la funzione di trasferimento dell'amplificatore

$A_1$  è la funzione di trasferimento della cella

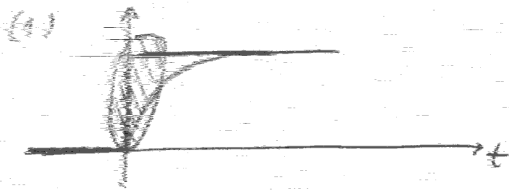
$A_2$  è la funzione di trasferimento dell'altra cella (in qst caso era il partitore nella maglia di sx.)

$A_m$  genera funz. di trasf. di altre celle. Un esempio può essere fatto con amplif. in cascata.

- $A_{TOT}(\omega = \rho) =$  serve per stabilire a che altezza è nel grafico dopo aver calcolato  $20 \log |A_{TOT}(\omega = \rho)| = A_{TOT} \text{ dB}$

$A_v^m$  è il fattore di amplificazione dell'amplificatore stesso. L'm di  $A_v^m$  si riferisce al # di invertimenti che amplificano il segnale.

→ ANALISI CIRCUITI RC: Corrispondenze tempo-frequenza

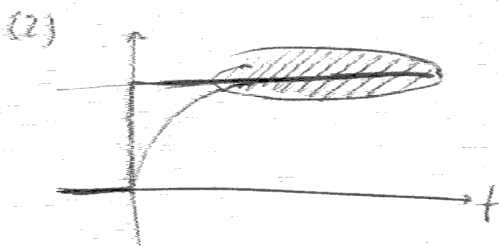


Il fronte del gradino ha componenti spettrali a frequenza elevata.

→ @  $f \rightarrow \infty$  e  $t = 0$  in corrispondenza del gradino:

$Z(C) = \phi$  (corto circuito) CONDENSATORE

$Z(L) \rightarrow \infty$  (circuito aperto) INDUTTORE

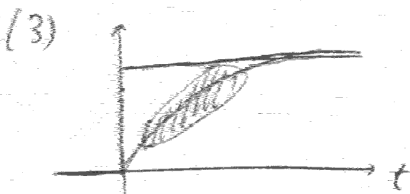


A transitorio esaurito, il gradino è una continua (costante)

→ @  $f = 0$  e  $t \rightarrow \infty$  (a regime)

$Z(C) \rightarrow \infty$  (circuito aperto) CONDENSATORE

$Z(L) = \phi$  (corto circuito) INDUTTORE



Nel transitorio (a temp. intermed.)

→ CELE I ORDINE (RC o RL): andamento esponenziale (solo un componente reattivo)

→ CELE II ORDINE (RLC): andamento sinusoidale smorzato ed esponenziale (con più di un componente reattivo)

→ AMPLIFICATORE A BANDA PASSANTE  $(B_p)$

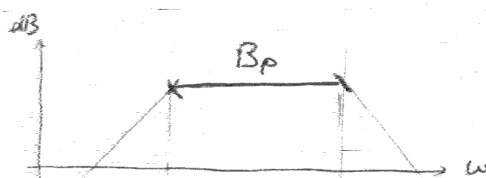
Consiste in un amplificatore che vede un P.A. all'ingresso ed un P.B. all'uscita.

→ Polo 1:  $\omega = \omega_1$  P.A., freq. taglio inferiore  $f_1 = \omega_1 / 2\pi$

→ Polo 2:  $\omega = \omega_2$  P.B., freq. taglio superiore  $f_2 = \omega_2 / 2\pi$

→ Da  $\omega_1$  a  $\omega_2$ : BANDA PASSANTE  $B_p$   $\omega_1 < \omega_2 \rightarrow$  CASO PIU' UTILE

Intuitivamente:



da

$$V_c = AvV_2 \frac{R_2}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} = AvV_2 \frac{R_2}{\frac{1 + sC_2R_2}{sC_2}} = AvV_2 \frac{sC_2R_2}{sC_2R_2 + 1} = V_c$$

Sostituendo  $V_2$  abbiamo:

$$V_c = Av \frac{V_4}{(sC_1(R_4 + R_1) + 1)} \cdot \frac{sC_2R_2}{sC_2R_2 + 1}$$

$V_2$

$(s = j\omega)$

@  $\omega = 0 \Rightarrow A_{TOT}(0) = 0$

$$A_{TOT} = \frac{V_c}{V_4} = \left[ \frac{Av}{V_4} \frac{sC_2R_2}{sC_1(R_4 + R_1) + 1} \right]$$

@  $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow A_{TOT}(\infty) = 0$

$A_{TOT}(0) = 0$  effetto della cella passa alto all'uscita } amplificazione  
 $A_{TOT}(\infty) = 0$  effetto della cella passa basso all'ingresso } nulla

Le costanti di tempo le abbiamo già calcolate indirettamente quando abbiamo calcolato le varie tensioni della cella. Per la cella passa-basso:

$$\frac{V_2}{V_4} = \frac{1}{1 + sC_1(R_4 + R_1)} = \frac{1}{\tau_2 + s} \Rightarrow \omega_2 = \frac{1}{\tau_2}$$

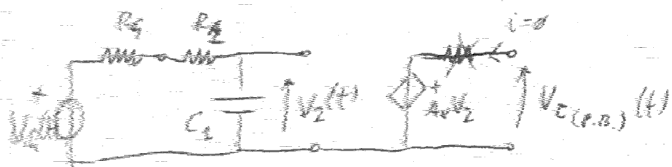
La chiamiamo  $\omega_2$  perché essendo il polo della cella passa-basso è più grande  
 $\omega_2 > \omega_1$ , dove  $\omega_1$  lo calcoliamo da:

• Per la cella passa-alto:

$$\frac{V_c}{AvV_2} = \frac{sC_2R_2}{sC_1(R_4 + R_1) + 1} = \frac{sC_2R_2}{\tau_1 + s} \Rightarrow \omega_1 = \frac{1}{\tau_1}$$

$\omega_1 < \omega_2$  polo della cella passa-alto

cella P.B.



$$V_G(t) = \begin{cases} \text{per } t < 0 & V_G(t) = 0 \\ \text{per } t > 0 & V_G(t) = V_G \end{cases}$$

suppl. con cella P.B.

$$V_2(t) = [V_2(0^-) - V_2(\infty)] e^{-t/\tau} + V_2(\infty)$$

I calcol. sono gli stessi fatti per la cella P.B.:

$$V_2(0^-) = 0$$

$$V_2(\infty) = V_G$$

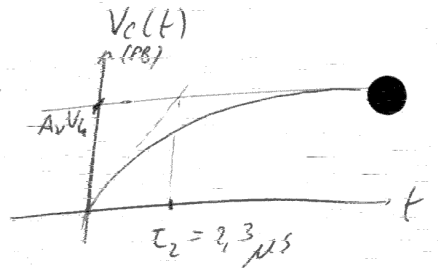
$$\rightarrow V_2(t) = V_G (1 - e^{-t/\tau})$$

$$\text{@ } t=0 \rightarrow V_2(t) = 0$$

$$\text{@ } t \rightarrow \infty \rightarrow V_2(t) = V_G$$

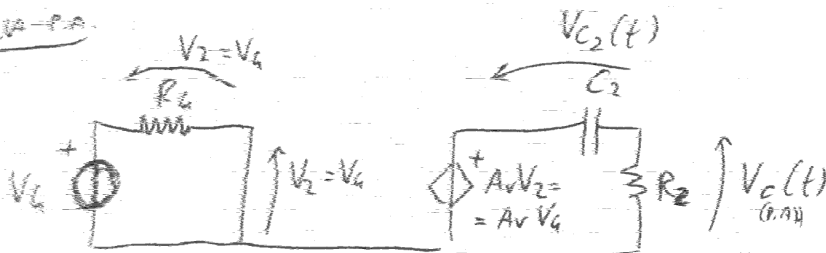
$$V_{C_2}(t) = A_v V_2(t) = A_v V_G (1 - e^{-t/\tau})$$

$$\begin{cases} t=0 \rightarrow V_{C_2}(t) = 0 \\ t \rightarrow \infty \rightarrow V_{C_2}(t) = A_v V_G \end{cases}$$



$$\tau_2 = C_2 (R_G + R_A) = 2,3 \mu s$$

cella P.A.



$$V_C(t) = A_v V_2 - V_{C_2}(t)$$

$$V_C(t) = \begin{cases} t < 0 & V_C(t) = 0 \\ t > 0 & V_C(t) = V_G \end{cases}$$

$$V_2 = V_G$$

$$V_{C_2}(t) = [V_{C_2}(0^-) - V_{C_2}(\infty)] e^{-t/\tau} + V_{C_2}(\infty)$$

Anche qui i calcol. sono i medesimi per la cella P.A.:

$$V_{C_2}(0^-) = 0$$

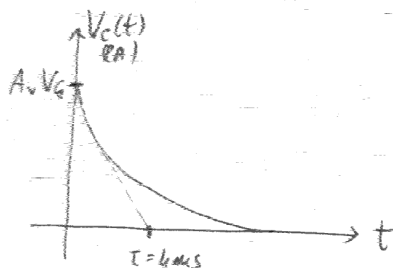
$$V_{C_2}(\infty) = A_v V_2 = A_v V_G \rightarrow V_{C_2}(t) = A_v V_G (1 - e^{-t/\tau})$$

$$V_C(t) = A_v V_2 - V_{C_2}(t) = A_v V_G - A_v V_G + A_v V_G e^{-t/\tau} = A_v V_G e^{-t/\tau}$$

$$t=0 \rightarrow V_C(t) = A_v V_G$$

$$t \rightarrow \infty \rightarrow V_C(t) = 0$$

$$\tau_1 = R_2 C_2 = 4 \text{ ms}$$



## → RELAZIONE TRA INGRESSO ED USCITA (IN/OUT)

La relazione tra ingresso ed uscita può essere espressa tramite un grafico. Tale grafico prende il nome di TRANSCHARATTERISTICA.

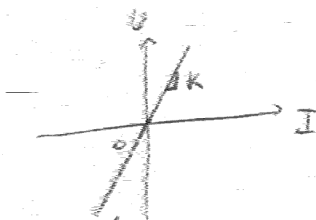
Le qst transcaratteristiche sono lineari (cioè rette, o in altre parole  $e'$  è uguale all'  $i'$  a meno di una costante moltiplicativa) viene denominata transcaratteristica lineare e i

dispositivi associati a tali transcaratteristiche sono detti moduli lineari.

Per la funz. d. Trasf. da informaz. dinamiche la transcaratteristica da inform. statiche

### → MODULI LINEARI IDEALI

Come detto la relazione I/O è rappresentabile da una retta e quindi lineare.



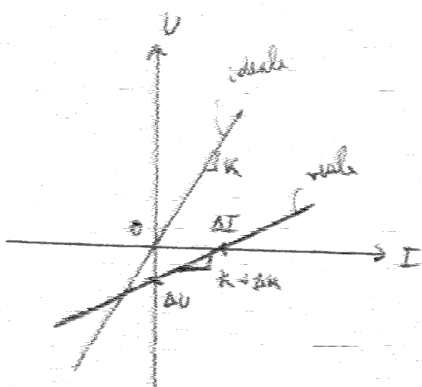
(retta che passa per l'origine).

$$U(I) = K I$$

Vali il principio di sovrapposizione degli effetti:

$$U(A+B) = U(A)|_{B=0} + U(B)|_{A=0}$$

### → MODULI LINEARI REALI



L'uscita reale non passa per l'origine

Avrà dunque:

$$(U + \Delta U) = (K + \Delta K) I$$

$$U = (K + \Delta K) I - \Delta U$$

} riferito all'uscita

$$U = (K + \Delta K)(I + \Delta I)$$

} riferito all'ingresso.

ERRORE del 1° ordine:

guadagno  $\rightarrow \Delta K$

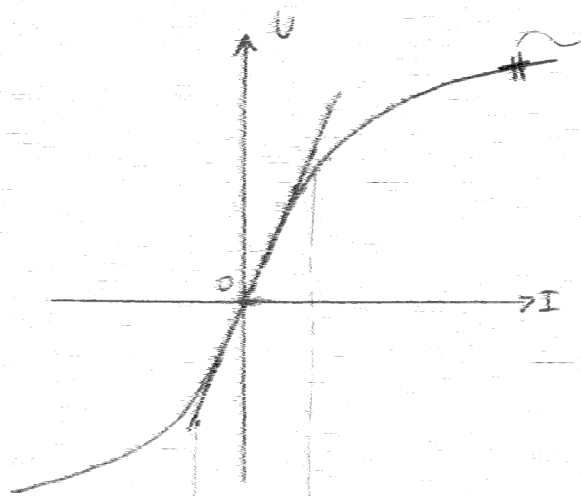
offset (i.t.o.)  $\rightarrow \Delta U$

offset (i.t.i.)  $\rightarrow \Delta I$

per ingresso nullo, avrà un'uscita  $\Delta U$ .

qst rappresenta il valore a cui devo far arrivare l'ingresso per ottenere un'uscita nulla.

Come suggerito dal grafico della trascaratteristica non lineare in tratti limitati è possibile approssimare una trascaratteristica non lineare con una lineare, nelle cosiddette regioni lineari.



Nelle regioni di saturazione se il segnale non subisce delle grandi variazioni lo può approssimare (tramite Taylor) delle piccole porzioni di trascaratteristica in una retta. La trascaratteristica può considerarsi ancora lineare. Se le variazioni sono grandi no, Ost "invece" viene detto RISPOSTA DEL PICCOLO SEGNALE.

regioni lineari in cui  
può applicarsi il  
modello lineare  $U=KI$

### → LIMITI DELLA BANDA

Ovunque amplificatore (o modulo) ha di per sé (anche senza celle P.A. o P.B.) delle bande limitate, infatti non può fornire in uscita segnali ad infinite frequenze.

• LIMITE A BASSE FREQUENZE

$$f_a = 0 \quad (\text{AMPLIFICATORE DC})$$

$$f_a = f_1 \quad \text{frequenza di taglio inferiore}$$

• LIMITE AD ALTE FREQUENZE

$$f_b = \text{freq di taglio superiore}$$

Il rumore è presente a banda larga (praticamente  $\infty$ ) e dev'essere amplificato solo il segnale utile. Non ha senso fare un ampl. con banda illimitata, anzi, la banda passante dev'essere una specifica di progetto e deve essere progettata rispetto alla banda del segnale da amplificare. Una banda troppo grande farebbe sì che ci fosse troppo rumore e quindi il rapporto  $(\frac{S}{N})$  farebbe degradare non meno il segnale d'ingresso che si vuole amplificare.

### → DISTORSIONI E NON LINEARITÀ (THD - TOTAL HARMONIC DISTORSION)

La distorsione deriva dalla trascaratteristica non lineare. La distorsione di un segnale sinusoidale comporta alla presenza di ughe spettrali spinte a freq multiple dell'andamento. Sono anticipate dal THD. Idealmente THD = 0. Se THD grande l'amplificatore non ha

$$= \frac{1}{F(s)} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{F(s)A(s)}} = H(s)$$

FUNZIONE TRASFERIMENTO  
DELL' AMPL. REAZIONATO

Il termine  $F(s)A(s) = G(s)$  viene definito GUADAGNO D'ANFO.

$H(s)$  vale quando  $G(s) < 0$  oppure  $G(s) > 0$  ma inferiore all' unita'.

Analizzando si ottiene l'espressione del segnale d'ingresso dell'amplificatore reazionato:

$$E = S_{in} + S_{out} F(s) = S_{in} + \underbrace{E A(s)}_{S_{out}} F(s) \Rightarrow E(1 - A(s)F(s)) = S_{in}$$

$$\Rightarrow E = \frac{S_{in}}{1 - A(s)F(s)}$$

Segnale ingresso reazionato  
(detto anche segnale d'errore)  
( $E = S_f + S_{in}$ )

e il segnale di reazione

$$S_f = S_{out} F(s) = \underbrace{E A(s)}_{= S_{out}} F(s) = \frac{S_{in} (A(s)F(s))}{1 - A(s)F(s)} = S_f$$

$(E = \frac{S_{in}}{1 - A(s)F(s)})$

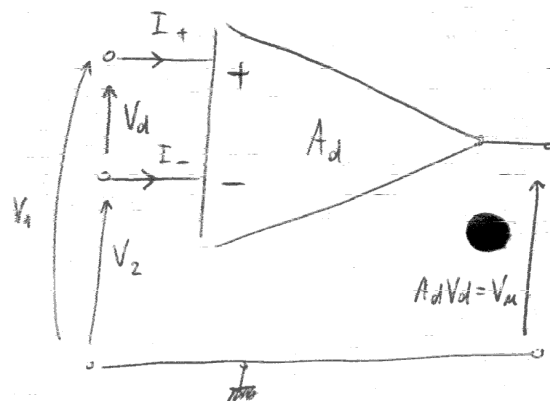
segnale di  
reazione  
(proporzionale ad  $S_{out}$ )

→ Nel caso in cui  $A(s)F(s) \rightarrow \infty$  allora  $H(s) \approx -\frac{1}{F(s)}$  ed  $E = \phi$

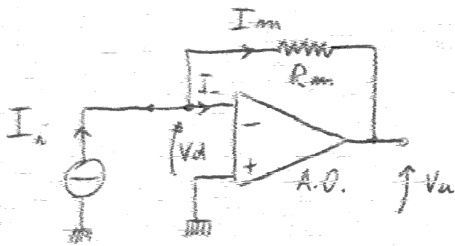
oss: Qst formula evidenzia il fatto che (in condizioni ideali) il trasferimento non dipende più dal blocco di andata ( $A(s)$ ) ma solo dalle caratteristiche del blocco di reazione  $F(s)$ . Di conseguenza bastera garantire solo la tolleranza del blocco di reazione.

### → PARAMETRI DELL' A.O. IDEALE

- Correnti nulle  $I_+ = I_- = \phi$
- Tensione differenziale nulla  $V_d = V_1 - V_2 = 0 \Rightarrow V_1 = V_2$  (morsetti equipotenziali)
- $|A_d| \rightarrow \infty$
- Morsetti: + : morsetto non invertente  
- : morsetto invertente
- $R_{D_{in}} = \infty$  resistenza d'uscita idealmente nulla

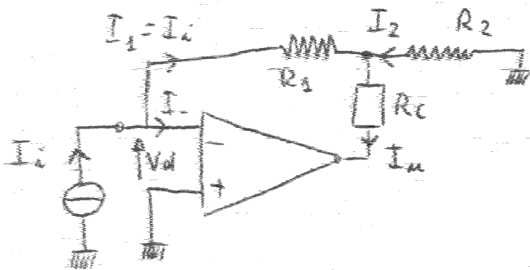


INVERTENTI (Caratterizzati da Ri BASSA)



$I \rightarrow V$

$R_i = \phi$   
 $R_u = \phi$  } Stessi parametri usati nel capitolo 2 (all'AMPLIFICATORE)

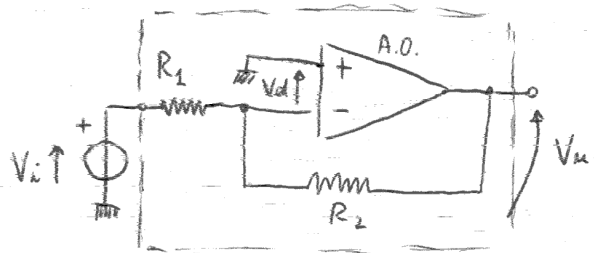
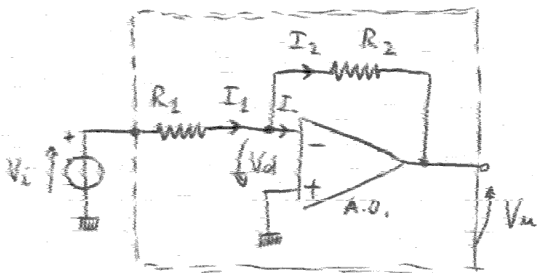


$I \rightarrow I$

$R_i = 0$   
 $R_u \rightarrow \infty$  } Stessi parametri usati nel capitolo 2 (all'AMPLIFICATORE)

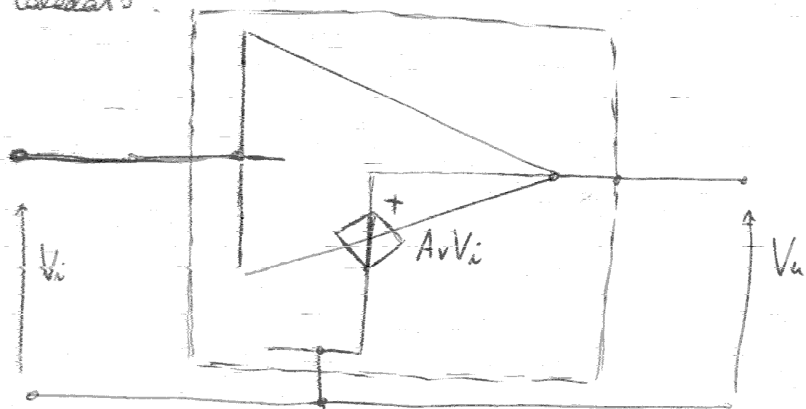
$\rightarrow$  Se  $R_2 \rightarrow \infty$  ed  $R_1 = \phi$   $\rightarrow$  BUFFER DI CORRENTE  
 (C.A.) (C.C.)

Le più comuni rappresentazioni degli amplificatori invertenti sono le seguenti:



$$A_v = - \frac{V_u}{V_i} = - \frac{R_2}{R_1}$$

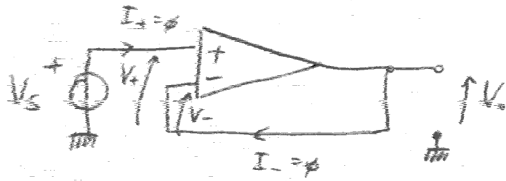
oss: Come prima anche in qst caso i rognacchi possono essere rappresentati dal suo circuito equivalente rappresentato come un amplificatore con guadagno  $A_v$  calcolato.





## BUFFER A GUADAGNO UNITARIO (OD INSEQUITORE DI TENSIONE - VOLTAGE FOLLOWER)

È un caso particolare dell'amplificatore non invertente  $V \rightarrow V$  in cui la  $R_1 \rightarrow \infty$  (circuito aperto) e la  $R_2 = 0$  (corto circuito).

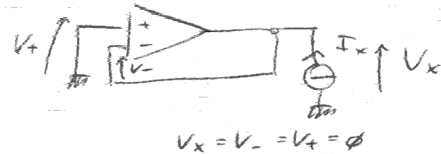


$$V_o = V_- = V_+ = V_s \Rightarrow V_o = V_s$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_s} = 1$$

$$\bullet R_i = \frac{V_s}{I_+} = \frac{V_s}{0} \rightarrow \infty$$

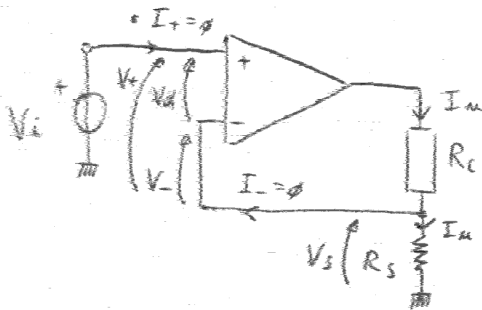
$$\bullet R_u = \frac{V_x}{I_x} = 0$$



$$V_x = V_- = V_+ = 0$$

La  $R_i \rightarrow \infty$  e la  $R_u = 0$  e quindi realizza una trasformazione notevole a livello d'impedenza mantenendo inalterato (per il guadagno unitario  $A_v = 1$ ) il livello del segnale. (Esempi possono essere sensori e sistemi per acquisizione dati).

## AMPLIFICATORE NON INVERTENTE $V \rightarrow I$



Amplificatore di transconduttanza

$$V_s = V_- = V_+ = V_i \Rightarrow V_s = V_i$$

$$I_n = \frac{V_s}{R_s} = \frac{V_i}{R_s}$$

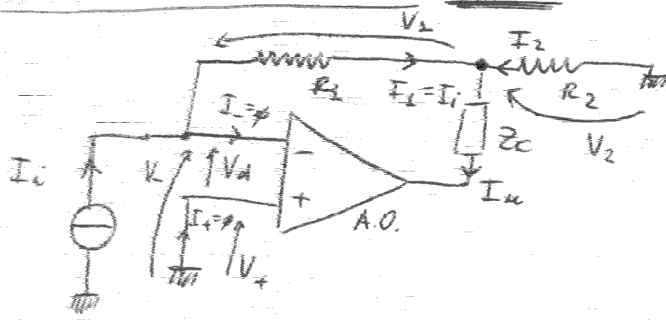
$$G_m = \frac{I_n}{V_i} = \frac{1}{R_s}$$

TRANSCONDUTTANZA

$$\bullet R_i = \frac{V_i}{I_+} = \frac{V_i}{0} \rightarrow \infty \quad \boxed{R_i \rightarrow \infty}$$

$$\bullet \boxed{R_u \rightarrow \infty}$$

→ AMPLIFICATORE INVERTENTE I → I



Vincoli dell'A.O. ideale

$$\begin{cases} V_d = 0 \Rightarrow V_+ = V_- = 0 \\ I_+ = I_- = 0 \end{cases}$$

$$\downarrow \\ I_1 = I_i$$

$$R_1 \parallel R_2 \Rightarrow V_1 = V_2 \Rightarrow I_1 R_1 = I_2 R_2$$

$$I_u = I_1 + I_2 = I_i + I_i \frac{R_1}{R_2} = I_i \left( 1 + \frac{R_1}{R_2} \right) = I_i \left( \frac{R_1 + R_2}{R_2} \right) = I_u$$

Relazione il guadagno

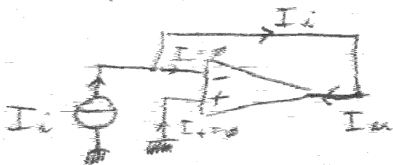
$$A_v = \frac{I_u}{I_i} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

•  $R_i \rightarrow \infty$

•  $R_u \rightarrow \infty$

BUFFER A GUADAGNO UNITARIO (OO INSEGUITORE DI CORRENTE) I → I

È un caso particolare di amplificatore invertente I → I in cui  $R_2 \rightarrow \infty$  (circuito aperto) e  $R_1 = 0$  (corto circuito).



Si vede subito che per via di  $I_- = 0$

$$\Rightarrow I_i = I_u$$

Da cui:

$$A_v = \frac{I_u}{I_i} = 1$$

Altrimenti:

→ Per configurazioni non invertenti

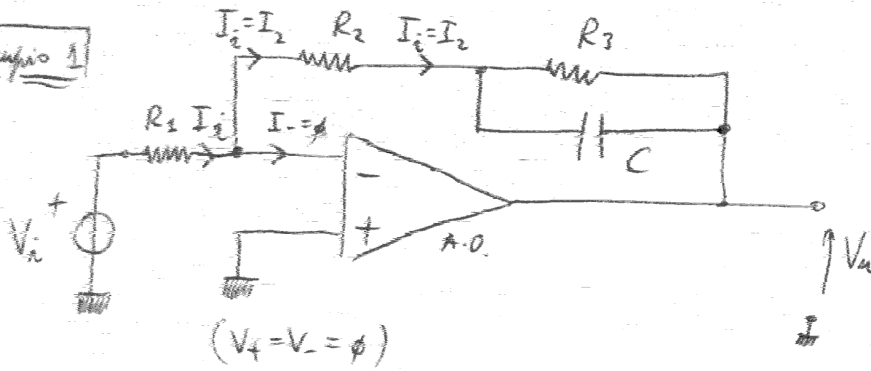
\* equazioni alle maglie d'ingresso con il vincolo dell'amplif. operazionale

$$V_d = 0.$$

→ Per configurazioni invertenti

\* massa virtuale, equazioni correnti su ingresso invertente (-).

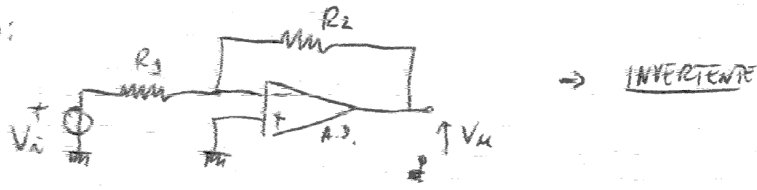
Esempio 1



Comportamento asintotico

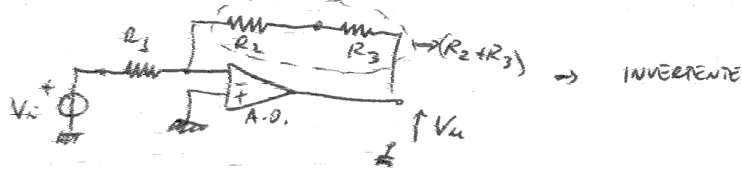
$\omega \rightarrow \infty \quad C \rightarrow c.c. \Rightarrow R_3 = \phi$

Amplificatore invertente:



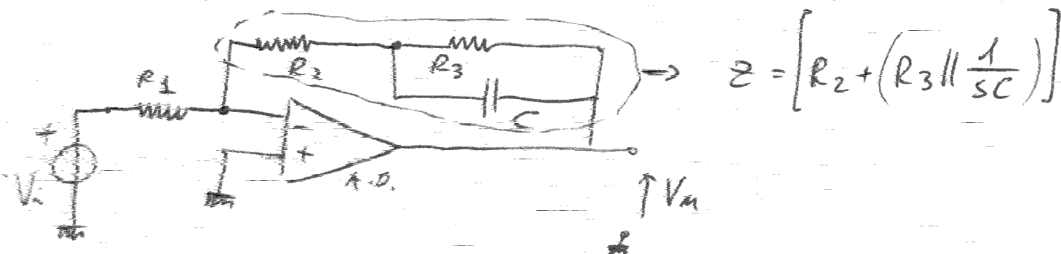
Partanto:  $V_u = - \frac{R_2}{R_1} V_i \quad (\omega \rightarrow \infty)$

$\omega \rightarrow 0 \quad C \rightarrow c.a. \Rightarrow$  Amplificatore  $R_2$  ed  $R_3$  in serie



Partanto:  $V_u = - \frac{(R_2 + R_3)}{R_1} V_i \quad (\omega \rightarrow 0)$

Fdt: posizione poli e zeri



Partanto:  $V_u = - \frac{Z}{R_1} V_i \Rightarrow$  Fdt:  $\frac{V_u}{V_i} = - \frac{Z}{R_1}$

Calcolando  $Z$ :  $Z = R_2 + \frac{R_3}{1 + sCR_3} = R_2 + \frac{R_3}{1 + sCR_3} = \frac{R_2 + R_3 + sCR_3 R_2}{1 + sCR_3} = Z$

oss: Si può anche vedere come il rapporto incrementale:

$$\frac{A_{v\infty} |_{dB} - A_{v0} |_{dB}}{\log \omega_2 - \log \omega_1} = -20 \text{ dB/dec} \Rightarrow \frac{20 \log A_{v\infty} - 20 \log A_{v0}}{\log \omega_2 - \log \omega_1} = -20 \text{ dB/dec} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 20 \frac{\log \frac{A_{v\infty}}{A_{v0}}}{\log \frac{\omega_2}{\omega_1}} = -20 \Rightarrow \frac{A_{v\infty}}{A_{v0}} |_{dB} = - \frac{\omega_2}{\omega_1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\left| \frac{A_{v\infty}}{A_{v0}} \right|_{dB} = \left| \frac{\omega_2}{\omega_1} \right|}$$

Ora annunciamo i dati della slide 8

$$R_1 = 12 \text{ k}\Omega, R_2 = 33 \text{ k}\Omega, R_3 = 120 \text{ k}\Omega$$

$$C = 2,2 \text{ nF}$$

Esprimiamo per comodità la f.d.t.:

$$\frac{V_u}{V_i} = A_v(s) = - \frac{(R_3 + R_2)}{R_1} \frac{[1 + sC(R_2 || R_3)]}{(1 + sCR_3)}$$

Nota: Se da applichiamo il comportamento asintotico alla f.d.t. invece che al circuito come abbiamo fatto prima otterremo i medesimi risultati:

$$s = j\omega$$

$$\bullet \frac{s \rightarrow \infty}{\omega \rightarrow \infty} = - \frac{R_3 + R_2}{R_1} \frac{1 + sC \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}}{1 + sCR_3} =$$

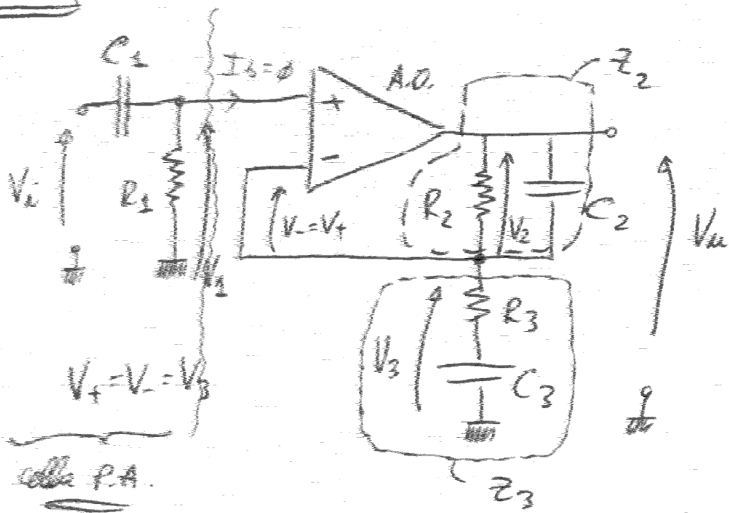
$$= - \frac{R_3 + R_2}{R_1} \cdot \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \frac{1}{R_3} = - \frac{R_2}{R_1} = A(\infty)$$

$$\bullet \frac{s \rightarrow 0}{\omega \rightarrow 0} = - \frac{R_3 + R_2}{R_1} \frac{1 + sC \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}}{1 + sCR_3} =$$

$$\boxed{- \frac{R_3 + R_2}{R_1} = A(0)}$$

c.v.d.  $\odot$

Esempio 2

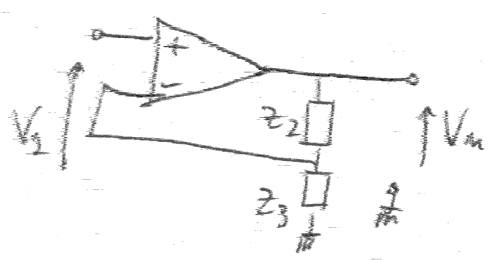


- $R_1 = 10k\Omega$
- $R_2 = 150k\Omega$
- $R_3 = 12k\Omega$
- $C_1 = 47\mu F$
- $C_2 = 100pF$
- $C_3 = 10\mu F$

$$Z_2 = R_2 \parallel \frac{1}{sC_2} = \frac{R_2 \cdot \frac{1}{sC_2}}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} = \frac{R_2}{1 + sR_2C_2} = Z_2$$

$$Z_3 = R_3 + \frac{1}{sC_3} = \frac{sR_3C_3 + 1}{sC_3}$$

per ora non comprendiamo la cello P.A.



$$\frac{V_u}{V_i} = 1 + \frac{Z_2}{Z_3}$$

$$\frac{V_u}{V_i} = A_v(s) = 1 + \left[ \frac{R_2}{1 + sR_2C_2} \cdot \frac{sC_3}{1 + sR_3C_3} \right] = \frac{(1 + sR_2C_2)(1 + sR_3C_3) + sR_2C_3}{(1 + sR_2C_2)(1 + sR_3C_3)}$$

$$= \frac{1 + sR_3C_3 + sR_2C_2 + s^2R_2R_3C_2C_3 + sR_2C_3}{(1 + sR_2C_2)(1 + sR_3C_3)} = \frac{s^2(R_2R_3C_2C_3) + s(C_2R_2 + C_3R_3 + C_3R_2) + 1}{(1 + sR_2C_2)(1 + sR_3C_3)}$$

$$= \frac{(1 + s\tau_{z1})(1 + s\tau_{z2})}{(1 + s\tau_2)(1 + s\tau_3)}$$

- zoh
- $\tau_{z1} = 1,62s$
- $\tau_{z2} = 1,11\mu s$
- pol
- $\tau_2 = C_2R_2 = 15\mu s$
- $\tau_3 = C_3R_3 = 120ms$

(effetto complesso)

• Sulla f.d.t.

$$1 + \frac{Z_2}{Z_3} \Rightarrow Z_2 = \frac{R_2}{1 + sR_2C_2}$$

$$Z_3 = R_3 + \frac{1}{sC_3}$$

$|s \rightarrow 0|$

$$Z_2 = R_2$$

$$Z_3 = \infty$$

$$\rightarrow 1 + \frac{Z_2}{Z_3} = 1 + \frac{R_2}{\infty} = 1$$

$|s \rightarrow \infty|$

$$Z_2 = \phi$$

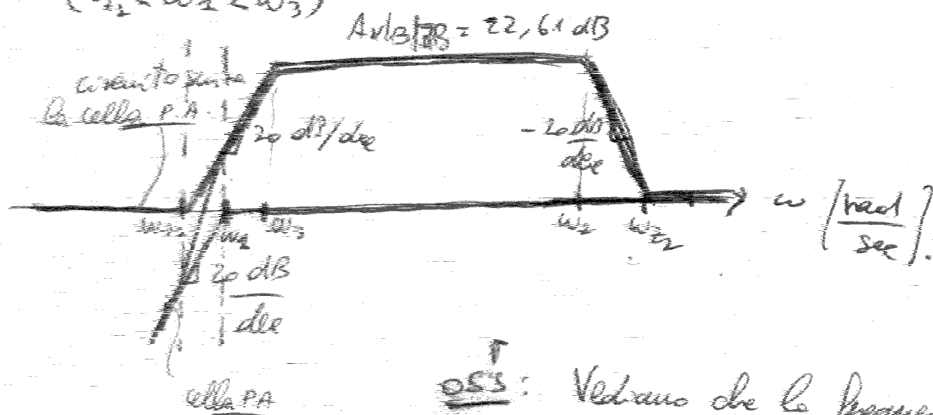
$$Z_3 = R_3$$

$$\rightarrow 1 + \frac{Z_2}{Z_3} = 1 + \frac{\phi}{R_3} = 1$$

c.v.d

Rappresentazione graf. asintote

→  $\boxed{\text{caso } \tau_3 < \tau_1 < \tau_2}$  dove  $\tau_1$  è il polo della cella P.A.  
 $(\omega_2 < \omega_1 < \omega_3)$



Qst è un caso particolare (non vale in general)

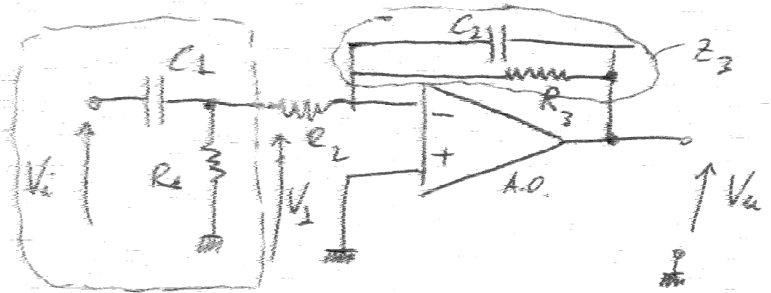
**Oss:** Vediamo che la frequenza del condensatore  $C_3$  quando  $\rightarrow \infty$  rispetto alla freq. del condensatore  $C_2$  è molto prima sulla scala logaritmica. Quindi il valore della banda passante si può vedere come un valore  $(A_{v|B})$  quando  $C_3$  è un c.c. ( $\omega_3 \rightarrow \infty$ ) e quando  $C_2$  è un c.a. ( $\omega_2 \rightarrow 0$ ).

Quindi dovremmo sommare il contributo di  $C_3(\omega \rightarrow \infty)$  e  $C_2(\omega \rightarrow \phi)$

$$Z_2 = \frac{R_2}{1 + sR_2C_2} \quad ; \quad Z_3 = R_3 + \frac{1}{sC_3}$$

$\bullet C_3(\omega \rightarrow \infty)$	$\bullet C_2(\omega \rightarrow \phi)$
$Z_2 = \phi$	$Z_2 = R_2$
$Z_3 = R_3$	$Z_3 = \infty$

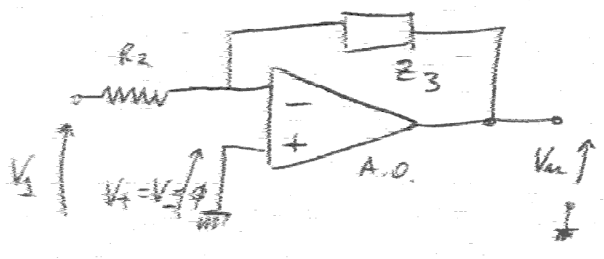
→ **AMPLIFICATORE AC INVERTENTE**



cella P.A. ⇒ (togli la continua)

$$Z_3 = R_3 \parallel \frac{1}{sC_2} = \frac{R_3/sC_2}{R_3 + \frac{1}{sC_2}} = \boxed{\frac{R_3}{1 + sC_2R_3} = Z_3}$$

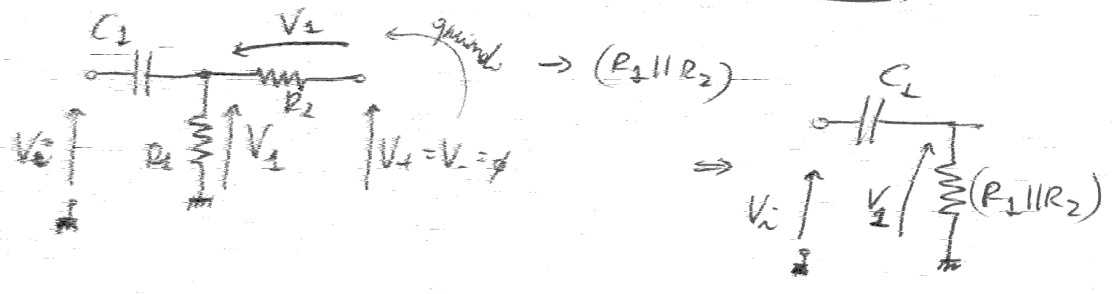
Caso prima analizziamo il circuito senza la cella P.A.



INV.

$$\frac{V_u}{V_1} = - \frac{Z_3}{R_2}$$

Per la cella P.A. ( $R_2$  si deve avere comprendibile)



$$V_2 = V_i \frac{R_2 \parallel R_1}{\frac{1}{sC_1} + (R_2 \parallel R_1)} \Rightarrow \frac{V_1}{V_i} = \frac{R_2 \parallel R_1}{\frac{1}{sC_1} + (R_2 \parallel R_1)}$$

In totale avremo:

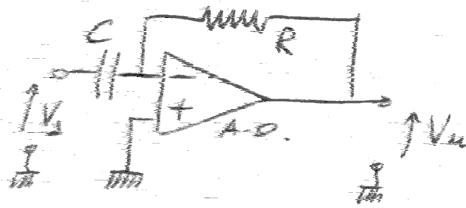
$$\frac{V_u}{V_i} = \frac{V_u}{V_1} \frac{V_1}{V_i} = - \frac{Z_3}{R_2} \frac{R_2 \parallel R_1}{\frac{1}{sC_1} + (R_2 \parallel R_1)} = A_v(s)$$

dove  $Z_3$  è l'impedenza calcolata all'inizio.



## DERIVATORE CON A.O.

→ Inserendo come elemento d'ingresso un condensatore si ottiene un DERIVATORE

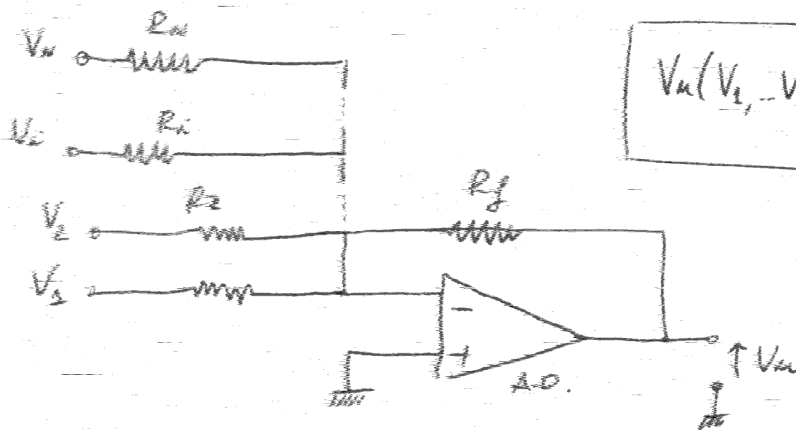


$$V_u(s) = -V_i(s) sRC$$

↓ proprietà di Laplace

$$V_u(t) = -RC \frac{dV_i(t)}{dt} \quad \left| \begin{array}{l} \text{nel} \\ \text{tempo} \end{array} \right.$$

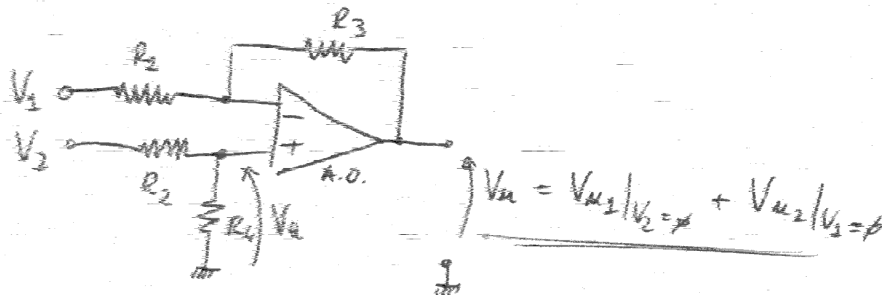
## SOMMATORE CON A.O.



$$V_u(V_1, \dots, V_n) = -R_f \left( \sum_{i=1}^n \frac{V_i}{R_i} \right) \quad I_i$$

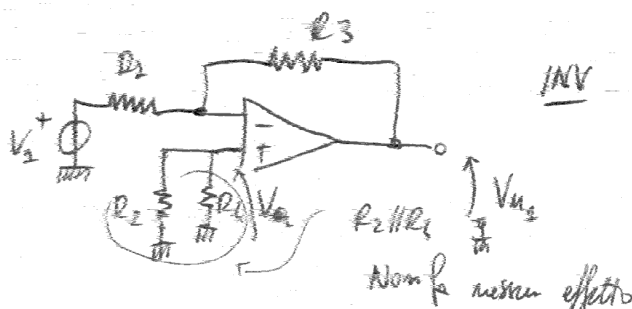
## AMPLIFICATORE DIFFERENZIALE CON A.O.

Applicazioni uguali sia al lato invertente che al lato non invertente.



principio di  
sovrapposizione degli  
effetti.

$$V_{u2}/V_2 = \beta$$



INV

$$V_{u1} = V_1 \left( -\frac{R_3}{R_1} \right)$$

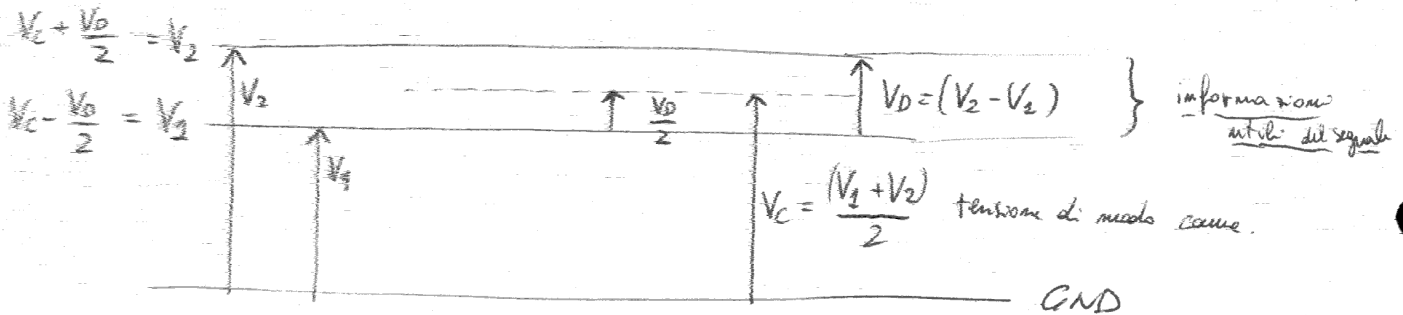
Non fa nessun effetto

Qst ampl. diff. massano perché il segnale differenziale creato è più immunito ai rumori rispetto agli altri segnali.

→ Le tensioni  $V_2$  e  $V_1$  possono essere scritte come somma di:

• un TERMINE DI MODO COMUNE  $V_C = \frac{(V_1+V_2)}{2}$  (disturbi)

• un TERMINE DIFFERENZIALE  $V_D = (V_2 - V_1)$  segnale "intelligente" (con le informazioni)



Formule utili:

$$\begin{cases} V_2 = V_C + \frac{V_D}{2} \\ V_1 = V_C - \frac{V_D}{2} \end{cases}$$

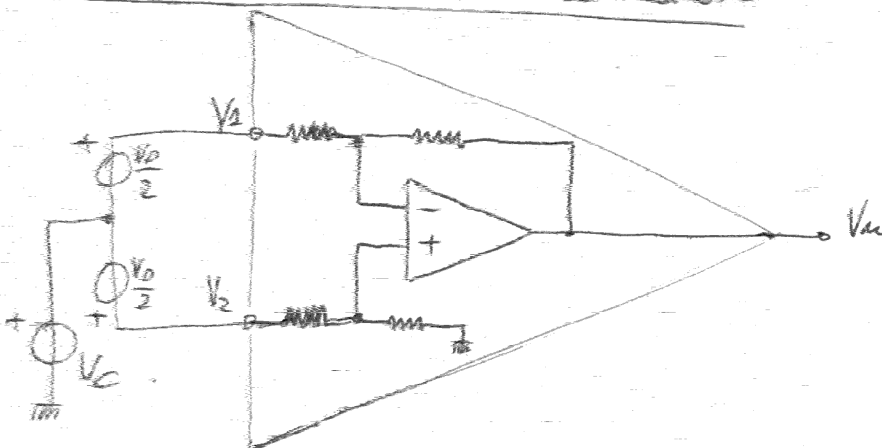
↔

$$\begin{cases} V_D = V_2 - V_1 \\ V_C = \frac{(V_1 + V_2)}{2} \end{cases}$$

tensione differenziale

tensione di modo comune

MODO DIFFERENZIALE E MODO COMUNE



Dal circuito infatti:

$$\begin{cases} V_1 = V_C - \frac{V_D}{2} \\ V_2 = V_C + \frac{V_D}{2} \end{cases}$$

⊕ segnale

$$V_u = A_1 V_1 + A_2 V_2 = A_1 \left( V_C - \frac{V_D}{2} \right) + A_2 \left( V_C + \frac{V_D}{2} \right) = \underbrace{(A_1 + A_2)}_{A_C} V_C + \underbrace{\frac{(A_2 - A_1)}{2}}_{A_D} V_D$$

$$= A_C V_C + A_D V_D$$

$$A_C = A_1 + A_2$$

AMPLIFICAZIONE DI MODO COMUNE

$$A_D = \frac{A_2 - A_1}{2}$$

AMPLIFICAZIONE DIFFERENZIALE

dove  $(A_1)$  è l'amplificazione del segnale  $V_1$ .  
 $(A_2)$  è l'amplificazione del segnale  $V_2$

## REIEZIONE DEL MODO COMUNE

Un buon amplificatore differenziale deve:

→ amplificare i segnali differenziali

$A_D$  ALTO

→ non amplificare i segnali di modo comune (disturbi)

$A_C$  BASSO

Quindi il rapporto  $\frac{A_D}{A_C}$  è molto importante perché indica quanto viene amplificato un segnale differenziale rispetto a quello di modo comune.

Definiamo  $\boxed{CMRR = \frac{A_D}{A_C}}$  (Common Mode Rejection Ratio)

- tolleranze resistenze
  - $A_D$  e  $A_C$  dell'operazionale
- } possono far diminuire il CMRR.

Il CMRR è un'informazione di quanto sia buono un amplificatore differenziale, più è alto più si avvicina al modello ideale e quindi, di conseguenza, sarà migliore.

## PASSARE DA $A_1, A_2$ AD $A_C, A_D$

•  $V_u$  è esprimibile come:

(1)  $V_u = A_1 V_1 + A_2 V_2$  (con  $A_1 \neq 0$ )

(2)  $V_u = A_D V_D + A_C V_C$

•  $A_1$  ed  $A_2$  dal circuito → passare ad  $A_D$  ed  $A_C$ ?

(I modo): sostituire algebricamente i valori nelle equazioni (1) (2) sopra.

(II modo): applicare la sovrapposizione degli effetti:

• SOLO SEGNALE COMUNE

$$V_1 = V_2 = V_C \quad (1) \quad V_u = A_C V_C = (A_1 + A_2) V_C \rightarrow \boxed{A_C = A_1 + A_2}$$

• SOLO SEGNALE DIFFERENZIALE

$$V_2 = -V_1 = \frac{V_D}{2} \quad (1) \quad V_u = A_D V_D = (A_2 - A_1) \frac{V_D}{2} \rightarrow \boxed{A_D = \frac{A_2 - A_1}{2}}$$

Dim. delle formule nel calcolo alternativo del CMRR (pross. foglio)

$$\begin{aligned} & \left( \begin{array}{l} A_C = A_1 + A_2 \\ A_D = \frac{A_2 - A_1}{2} \end{array} \right) \leftarrow \begin{array}{l} \text{(Sostituire alla (1))} \\ \text{(Sostituire alla (2))} \end{array} \\ & \left\{ \begin{array}{l} V_1 = V_C - \frac{V_D}{2} \\ V_2 = V_C + \frac{V_D}{2} \end{array} \right. \end{aligned}$$

$$\text{Se } \frac{R_3}{R_1} = \frac{R_4}{R_2} = A_x \Rightarrow A_D = \frac{1}{2} \left( A_x + \frac{A_x}{1+A_x} (1+A_x) \right) = \frac{1}{2} (2 A_x) = A_x = \frac{R_3}{R_1}$$

$$A_D = \frac{R_3}{R_1} = \frac{R_4}{R_2}$$

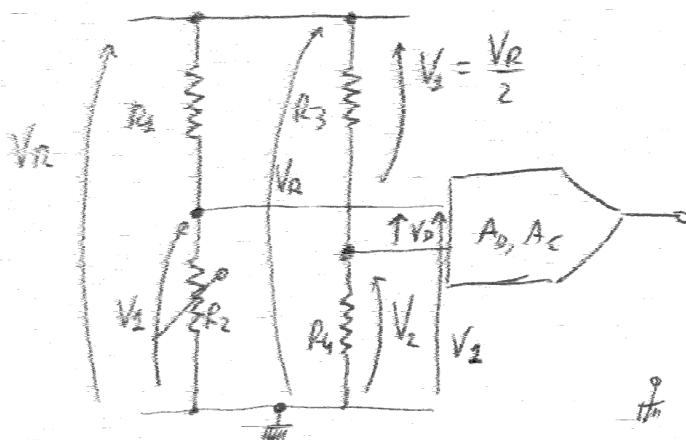
IR CMRR scala:

$$\text{CMRR} = \frac{A_D}{A_C} = \frac{R_3/R_1}{\emptyset} \rightarrow \infty$$

→ questo è il caso IDEALE

• In generale nel caso reale si deve tendere ad avere un  $A_C$  piccolo per massimizzare il CMRR con criteri di progetto adeguati.

Esercizio 4: point di resistenze



$$H_p: A_C = \emptyset$$

$$V_u = A_D V_D + A_C V_C = A_D V_D = V_u$$

$$V_D = V_1 - V_2$$

$$\frac{V_R}{2} = V_1 = V_2 + V_D$$

$$V_1 = V_2 + V_D \quad V_R = V_1 + V_2 + V_D$$

$$V_R = 2V_1 = 2(V_2 + V_D)$$

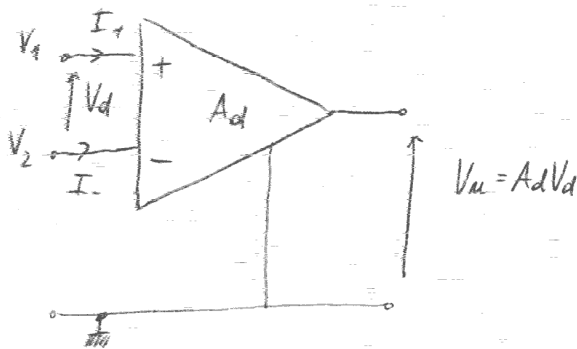
$$V_1 = V_R \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{P.T.}$$

$$V_2 = \frac{V_R}{2} \frac{R_4}{R_4 + R_3} \quad \text{P.T.}$$

# LEZIONE 06

## L'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE REALE

Come prima cosa vediamo un'occhiata all'A.O. ideale e ai suoi vincoli così da sottolineare le differenze dal modello reale.



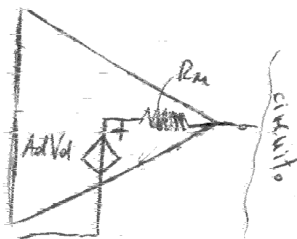
- $A_d \rightarrow \infty$   
GUADAGNO INFINITO

- $I_- = I_+ = 0$   
CORRENTI D'INGRESSO NULLE

- $V_d = \frac{V_u}{A_d} = 0$

$$V_d = V_1 - V_2 = 0 \Rightarrow |V_1 = V_2|$$

Tensione differenziale nulla



- Resistenza d'uscita

$$R_u = 0$$

non c'è perché qd che c'era attaccato avesse tensione pari a qd del generatore pilotato  $Ad \cdot V_d$

I DISPOSITIVI REALI hanno altre caratteristiche ovviamente:

- Guadagno differenziale  $A_d$  grande ma non  $\infty \Rightarrow V_d$  piccola ma non nulla.
- Correnti d'ingresso piccole ma non nulle
- Resistenza d'uscita piccola ma non nulla
- Funzione di trasferimento non lineare
- Banda passante  $B_p$  limitata ( $A_d$  piccolo per grandi frequenze  $\omega \gg \omega_c$ )
- Influenza di parametri esterni (temperatura, alimentazione e altro)

Occorre quindi un modello che consideri tutti qst effetti:

$$\rightarrow \text{L'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE REALE}$$

$$V_i = V_u \left( \frac{1}{A_d} + \beta \right) = V_u \left( \frac{1 + \beta A_d}{A_d} \right)$$

$$A_{v.m.i.} = \frac{V_u}{V_i} = \frac{1}{\frac{1 + \beta A_d}{A_d}} = \frac{A_d}{1 + \beta A_d} = \frac{1}{\frac{1}{A_d} + \beta} = \frac{1}{\beta} \frac{1}{1 + \frac{1}{\beta A_d}}$$

oss.: Vediamo subito che se  $A_d \rightarrow \infty$  torniamo al caso ideale  $A_v = \frac{1}{\beta}$

Nota:  $\beta^{-1} = \frac{1}{\beta} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 1 + \frac{R_1}{R_2} = A_v$  nel caso ideale  $\uparrow$

Includendo gm  $T = \beta A_d$ , avremo:

$$A_{v.m.i.} = \frac{V_u}{V_i} = \frac{1}{\beta} \frac{1}{1 + \frac{1}{\beta A_d}} = \frac{1}{\beta} \frac{1}{1 + \frac{1}{T}}$$

per  $A_d \rightarrow \infty$  anche  $T \rightarrow \infty$  e  $A_{v.m.i.} \rightarrow A_v$   
(il guadagno v.d. volta ideale)

Il termine  $\frac{1}{1 + \frac{1}{T}}$  può essere sviluppato matematicamente con McLaurin:

$$A_{v.m.i.} = \frac{1}{\beta} \frac{1}{1 + \frac{1}{T}} \approx \frac{1}{\beta} \left( 1 - \frac{1}{T} + \dots \right)$$

$$\boxed{\varepsilon_a = \frac{1}{T} = \frac{1}{\beta A_d}}$$

ERRORE DI QUADAGNO

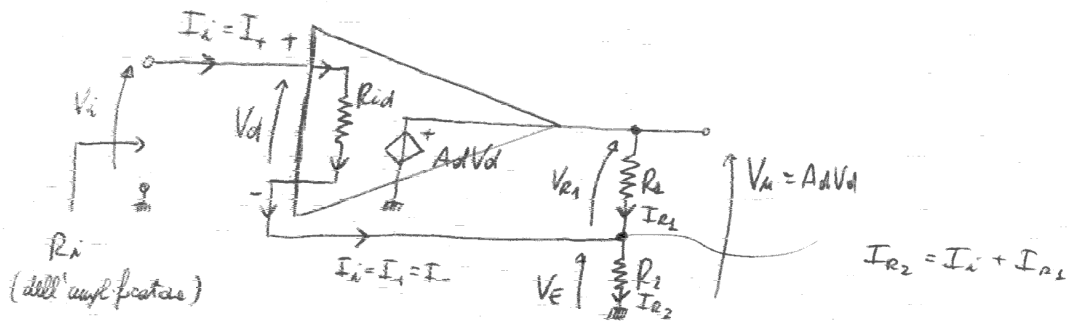
Quindi in generale con A.O. reale il guadagno:

→ è sempre più basso di qll ideale.

→ errore inversamente proporzionale all' $A_d$ , oppure

proporzionale a  $\frac{1}{\beta A_d} = \frac{1}{T}$

- RESISTENZA INGRESSO AMPLIFICATORE  $R_i$  (effetto di  $R_{id}$  ed  $A_d$ )



$$I_i = I_+ = I_- = \frac{V_d}{R_{id}} = \frac{V_u}{A_d R_{id}} = I_{in}$$

$$\left( V_u = A_d V_d \rightarrow V_d = \frac{V_u}{A_d} \right)$$

$$V_{R_1} = V_u - V_E$$

$$I_{R_1} = \frac{V_{R_1}}{R_1} = \frac{V_u - V_E}{R_1}$$

$$I_{R_2} = \frac{V_E}{R_2} \Rightarrow V_E = I_{R_2} R_2 \quad (\text{dove } I_{R_2} = I_i + I_{o1})$$

$$V_E = (I_i + I_{o1}) R_2 = R_2 \left( \frac{V_u}{A_d R_{id}} + \frac{V_u - V_E}{R_1} \right) = V_E$$

Svilgo il conto ed ottengo:

$$\frac{V_E}{R_2} = \left( \frac{V_u}{A_d R_{id}} + \frac{V_u}{R_1} - \frac{V_E}{R_1} \right) \Rightarrow \underbrace{\frac{V_E}{R_1} + \frac{V_E}{R_2}}_{V_E (R_1 \parallel R_2)^{-1}} = V_u \underbrace{\left( \frac{1}{A_d R_{id}} + \frac{1}{R_1} \right)}_{(A_d R_{id} \parallel R_1)^{-1}}$$

$$\Rightarrow V_E \frac{1}{(R_1 \parallel R_2)} = V_u \frac{1}{(A_d R_{id} \parallel R_1)} \Rightarrow V_E = V_u \frac{(R_1 \parallel R_2)}{(A_d R_{id} \parallel R_1)}$$

$$V_i = V_d + V_E = \frac{V_u}{A_d} + V_u \frac{(R_1 \parallel R_2)}{(A_d R_{id} \parallel R_1)} = V_u \left( \frac{1}{A_d} + \frac{(R_1 \parallel R_2)}{(A_d R_{id} \parallel R_1)} \right) = V_i$$

$$V_d = \frac{V_u}{A_d} - \frac{V_{k0}}{A_d}$$

$$V_u = V_d + V_{R_2} \Rightarrow V_d = -V_{R_2} \Rightarrow \frac{V_u}{A_d} - \frac{V_{k0}}{A_d} = -V_{R_2}$$

$$(P.T.) \quad V_{R_2} = V_u \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow V_d = -V_u \frac{R_2}{R_1 + R_2} = -V_u \beta$$

(con  $\beta$  fattore di partizione  $\beta = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ )

$$\boxed{V_d = -\beta V_u} \quad \left( \text{dove } \beta = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \text{ e } V_u = A_d V_d + V_{k0} \right) \quad \boxed{V_d = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} (A_d V_d + V_{k0})}$$

Dato che  $I_- = \phi \Rightarrow R_1$  in serie ad  $R_2 \Rightarrow R_1 + R_2$ , da cui:

$$\boxed{I_{R_2} = \frac{V_u}{R_1 + R_2}}$$

A prt pto sostituiamo tutto i valori nella  $V_u$ :

$$(V_u = A_d V_d + V_{k0})$$

$$V_u = A_d V_d + R_0 \underbrace{\left( I_u - I_{R_1} \right)}_{\substack{I_{k0} \\ (V_{k0} = R_0 I_{k0})}} = A_d (-\beta V_u) + R_0 \left( I_u - \frac{V_u}{R_1 + R_2} \right) = V_u$$

Sottraendo i calcoli anno':

$$1 = -\beta A_d + R_0 \frac{I_u}{V_u} - \frac{R_0}{R_1 + R_2} \quad (\text{diviso per } V_u)$$

$$\frac{I_u}{V_u} = \frac{\beta A_d}{R_0} + \frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_0}$$

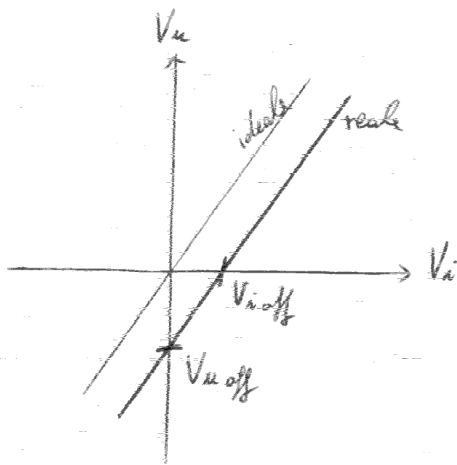
$$\frac{I_u}{V_u} = \frac{\beta A_d (R_1 + R_2) + R_0 + R_1 + R_2}{R_0 (R_1 + R_2)} = \frac{1}{R_u}$$

$$R_u = \frac{V_u}{I_u} = \frac{R_0 (R_1 + R_2)}{\beta A_d (R_1 + R_2) + R_0 + (R_1 + R_2)} = \frac{R_0}{\beta A_d + \frac{R_0}{(R_1 + R_2)} + 1} = R_u$$

diviso per  $(R_1 + R_2)$



(4) TENSIONE DI OFFSET DI INGRESSO E D' USCITA



Qst grafico (della caratteristica) rappresenta un andamento lineare.

Vediamo che se anche l'ingresso è zero si avrà un valore d'uscita.

Mentre  $V_{i\text{off}}$  indica il minimo valore che deve avere l'ingresso per far sì che la uscita sia nulla.

•  $V_{u\text{off}} = V_u$  per  $V_i = \emptyset$

L'obiettivo è minimizzare  $V_{u\text{off}}$

•  $V_{i\text{off}} = V_i$  per  $V_u = \emptyset$

MODELLO PER  $V_{i\text{off}}$  ( $V_{\text{off}}$ ) - INGRESSO

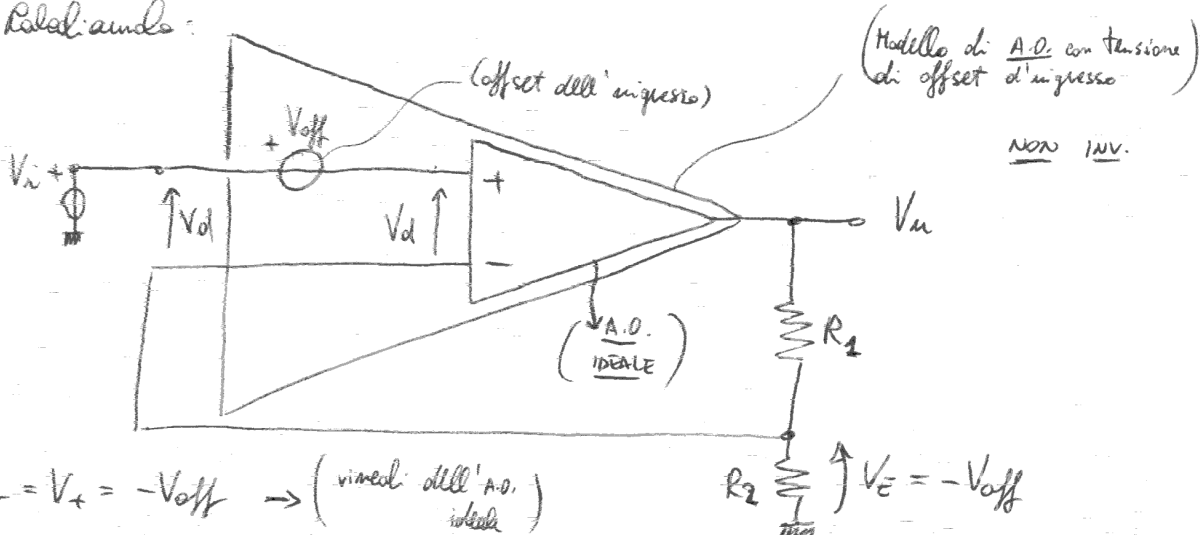
Nota: In tutti i data-sheet (i "bugiardini" degli A.O.) viene indicato il valore della tensione di offset d'ingresso  $V_{i\text{off}}$  come  $V_{\text{off}}$ .

La presenza di un certo valore di  $V_u \neq \emptyset$  per  $V_i = \emptyset$  viene modellata inserendo un generatore  $V_{\text{off}}$  nella maglia d'ingresso.

→ Quindi per  $V_i = V_{\text{off}} \Rightarrow V_u = \emptyset \Rightarrow V_E = \emptyset$   
(implicita)

•  $V_{\text{off}}$  è la tensione da applicare all'ingresso per ottenere  $V_u = \emptyset$ .

Realizzando:

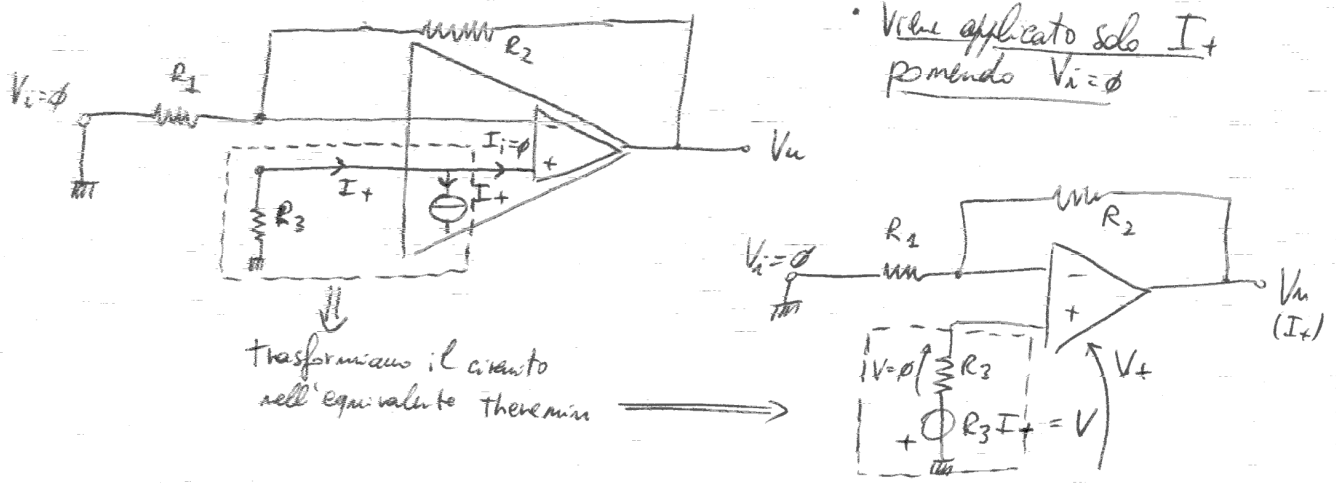


$V_E = V_- = V_+ = -V_{\text{off}} \rightarrow$  (vincol. dell'A.O. ideale)

$V_E = -V_{\text{off}}$

Ora valutiamo il contributo delle correnti d'ingresso alla tensione d'uscita. Tratteremo i due casi separati per poi unirli.  
 Questa trattazione vale sia per amplif. o. invertenti che non invertenti.

→ CONTRIBUTO A  $V_u$  DELLA CORRENTE  $I_+$

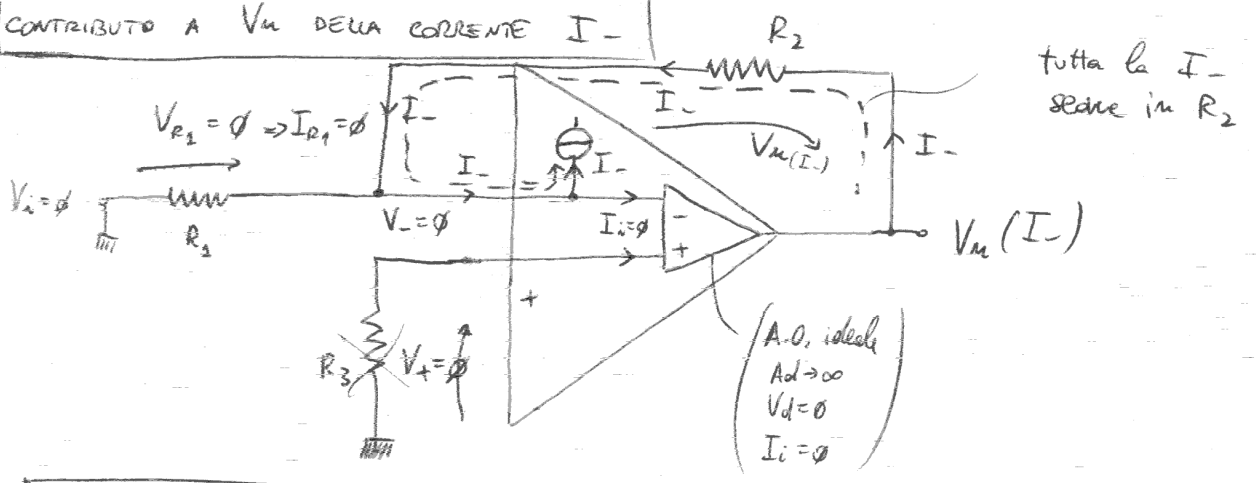


Quindi abbiamo un amplif. operazionale non invertente  $V_+ = -V_- = -R_3 I_+$

$$V_u = V_+ \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = -R_3 I_+ \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = V_u(I_+)$$

( $V_+ = -R_3 I_+$ )

→ CONTRIBUTO A  $V_u$  DELLA CORRENTE  $I_-$



$$V_u(I_-) = R_2 I_-$$

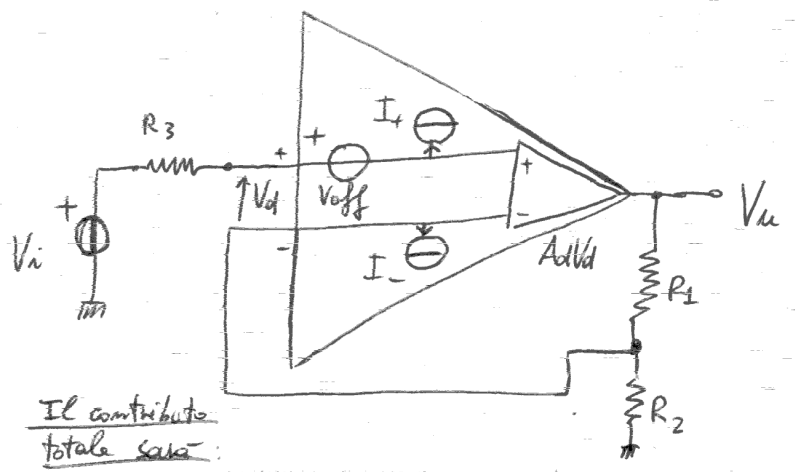
$$V_u(I_-) = -R_1 I_- \left( -\frac{R_2}{R_1} \right) = R_2 I_-$$

# MODELLO CON $V_{off}$ E CORRENTI D'INGRESSO $I_i$

→ (\*)  $V_u(V_{off}) = -V_{off} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$

↓ corrente

$$\begin{cases} V_u(I_-) = R_2 I_- \\ V_u(I_+) = -R_3 I_+ \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \\ |V_u(I_{off})| = \left[ R_3 \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) + R_2 \right] \frac{|I_{off}|}{2} \\ V_u(I_b) = \left[ -R_3 \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) + R_2 \right] I_b \end{cases}$$



Il contributo totale sarà:

$$V_{u,off} = |V_u(V_{off})| + V_u(I_b) + |V_u(I_{off})|$$

## OFFSET TOTALE IN USCITA

L'offset totale è dato dalla somma dei vari contributi:

- $|V_{i,off} = V_{off}|$  d'ingresso
- $V_u(V_{off}) = -V_{off} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$

- $I_+ = I_b + \frac{I_{off}}{2}$ ,  $I_- = I_b - \frac{I_{off}}{2}$  corrente d'ingresso

$$V_u(I_+, I_-) = \underbrace{-(R_3 I_+) \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)}_{V_u(I_+)} + \underbrace{R_2 I_-}_{V_u(I_-)}$$

L'offset totale sarà:

$$V_{u,off} = |V_u(V_{off})| + V_u(I_+) + V_u(I_-)$$

oppure

$$V_{u,off} = |V_u(V_{off})| + V_u(I_b) + |V_u(I_{off})| \quad (\text{in funzione di } I_b \text{ e di } I_{off})$$

Nota:  $I_b$  ha segno noto, mentre per  $V_{off}$  e  $I_{off}$  il segno non è noto.

- Se  $R_3 = R_1 \parallel R_2$

→ si annulla  $I_b$  ( $V_u(I_b) = 0$ )

(inf. all'A.O. disegnatq → e  $|V_u(I_{off})| = R_2 |I_{off}|$  : →

$$|V_{u,off}| = |V_u(V_{off})| + |V_u(I_{off})|$$

# LEZIONE 07

## I SEMICONDUCTORI

I parametri che caratterizzano i semiconduttori sono la

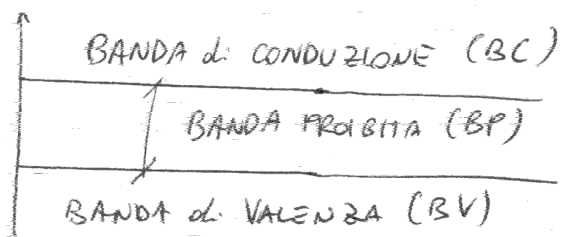
→ CONDUCIBILITÀ ELETTRICA  $\sigma$  [ $\frac{S}{cm}$ ]

→ RESISTIVITÀ ELETTRICA  $\rho = \frac{1}{\sigma}$  [ $\Omega cm$ ]

Sono caratterizzati da un cristallo con legami covalenti tra gli atomi. Per ogni atomo i 4 elettroni sul guscio più esterno sono condivisi con altri 4 atomi vicini.

In un reticolo cristallino formato da  $N$  atomi del IV gruppo della t.p. si hanno  $4N$  elettroni di valenza.

E



Solo gli elettroni nella banda di conduzione (BC) possono far generare conduzione elettrica.

Se gli elettroni sono tutti disposti nella BV anche se si applica un campo elettrico (c.e.) non è possibile generare corrente.

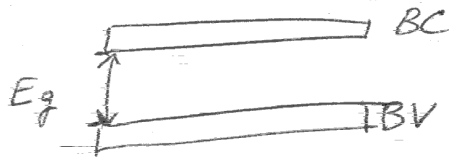
In generale gli elettroni tendono a distribuirsi sui vari livelli energetici partendo dal più basso (stato fondamentale)

@  $T = 0 K$ , la BV è totalmente occupata e la BC è totalmente vuota. Come detto in qst caso non è possibile generare corrente. (Una banda tutta piena o tutta vuota non genera corrente).

@  $T \neq 0 K$  alcuni elettroni "saltano" nella BC grazie ad un aumento dell'energia prodotta dalla temperatura.

In qst caso la BV è in parte vuota e la BC è in parte occupata.

Per far sì che gli elettroni "saltino" ad uno stato quantico a maggior energia c'è bisogno che superino una energy-gap della BP. Più gst è piccola più la probabilità del salto dell'elettrone è alta.



Qst  $E_g$  è una funzione decrescente della temperatura

$$BV \rightarrow BC \propto e^{-\frac{E_g}{k_B T}}$$

$E_g$  → energy gap (energia da fornire per il salto)  
 $T$  → temperatura (maggiore è  $T$  minore è  $E_g$ )  
 $k_B$  → cost. di Boltzmann ( $8,62 \times 10^{-5} \frac{eV}{K}$ ) =  
 $(k_B T = 26 \text{ meV} @ T = 300K)$

Così tanto è più grande  $T$  tanto più piccola è  $E_g$  (e quindi maggior probabilità dell'elettrone di "saltare" nella BC).

Nei semiconduttori  $E_g$  è dell'ordine degli eV

$$1 \text{ eV} = q \times (\Delta V = 1V) = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J (Joules)}$$

1 eV = 1 qV  
 $q \rightarrow [C]$   
 1 eV = 1 CV (CV = J)  
 1 eV = 1 J  
 Nota: (unità di misura).

Nota: la differenza di energia potenziale in eV è uguale alla differenza di potenziale elettrostatico

Un altro parametro dipendente dall' $E_g$  è la distanza rettilinea tra gli atomi. Indicata con  $a$ .

All'aumentare dell' $E_g$   $a$  diminuisce. Quindi quando l' $E_g$  è grande gli atomi del reticolo cristallino del materiale sono vicini.

In un SEMICONDUOTTORE PURO (O INTRINSECO), il # di elettroni e delle lacune sono in equilibrio. Qst equil. brno è dettato tra 2 fenomeni:

- GENERAZIONE: formazione di coppie elettrone-lacuna
- RICOMBINAZIONE di coppie elettrone-lacuna per la ricomposizione di un legame covalente.

Le concentrazioni di  $n$  e  $p$  sono uguali.  
 $(n_i)$  è chiamata CONCENTRAZIONE INTRINSECA

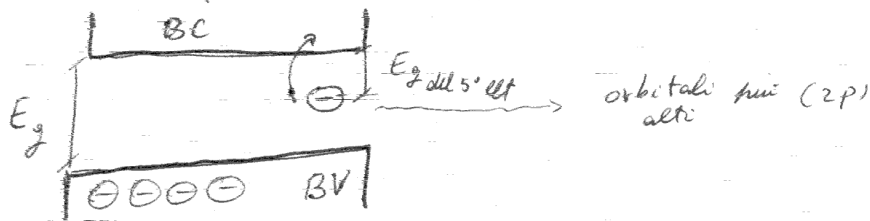
$$n = p = n_i$$

dipende solo dal tipo del materiale.  
 in un semiconduttore puro

→ SEMICONDUCTORE DROGATO DI TIPO N (IMPURITÀ DI TIPO DONATORE)

Come detto per il silicio si usano elementi di drogaggio che rispondano agli elementi appartenenti alla V colonna della t.p. (il più utilizzati sono il fosforo, l'arsenico e l'antimonio).

Quando uno di qst elementi prende il posto di un atomo di silicio nella struttura cristallina quattro dei 5 elettroni formano legami di tipo covalenti e il 5° occupa una posizione "in attesa" rispetto alla banda di conduzione usuale e pertanto sono più facili farli fare il "salto" (perché c'è una  $E_g$  minore). Qst perdita dell'elettrone da parte dell'atomo (se avviene) fa sì che qst'ultimo si ionizzi positivamente  $+q$  e diventi uno ione positivo che occupa una posizione fissa nel reticolo (a diff. dell'elettrone libero che potrà muoversi).



→ SEMICONDUCTORE DROGATO DI TIPO P

Si usano gli elementi della III colonna (o gruppo) che hanno 3 elettroni sul guscio più esterno. Un elettrone che si trova nella rimanenza dell'atomo di boro (B) ad esempio può essere facilmente accettato per formare quattro legami covalenti con gli atomi di silicio adiacenti. Qst processo genera una lacuna che può spostarsi nel reticolo cristallino. Per contro, l'atomo di boro diventerà carico negativamente (ione negativo  $-q$ ).

# atomi di drogaggio (impurità)   
 {   
 >> rispetto alla concentrazione intrinseca  $n_i$ .   
 << rispetto al # di atomi che formano il reticolo cristallino.

- Indichiamo con  $N_D$  la concentrazione [ $\text{cm}^{-3}$ ] di atomi donatori inseriti e con  $N_D^+$  la concentrazione di atomi donatori ionizzati. Quest'ultimi sono coloro che effettivamente hanno "donato" l'elettrone formando un elettrone libero. (Infatti non è certo che tutti gli atomi donatori inseriti tramite drogaggio donino l'elettrone ma almeno solo della densità di probabilità). TIPO N.

@  $T = 300 \text{ K}$  si ha  $N_D^+ \approx N_D$

- Indichiamo con  $N_A$  la concentrazione [ $\text{cm}^{-3}$ ] di atomi accettori inseriti e con  $N_A^-$  la concentrazione di atomi accettori ionizzati. Così gli che hanno "accettato" un elettrone generando una lacuna (come prima spiegato anche qua si tratta di probabilità). TIPO P.

@  $T = 300 \text{ K}$  si ha  $N_A^- \approx N_A$

### → NEUTRALITÀ ELETTRICA

Consideriamo un campione di semiconduttore a  $300 \text{ K}$  drogato con atomi donatori  $N_D$  ed atomi accettori  $N_A$  per unità di volume.

Nel campione avvino:

- CARICHE POSITIVE MOBILI (le lacune  $p$ ) e CARICHE POSITIVE FISSE (atomi donatori ionizzati  $N_D^+ \approx N_D$ ).
- CARICHE NEGATIVE MOBILI (gl. elt. liberi  $n$ ) CARICHE NEGATIVE FISSE (atomi accettori ionizzati  $N_A^- \approx N_A$ ).

Se il campione è OMOGENEO (cioè le impurità sono p.to per p.to costanti) deve essere localmente neutro (cioè cariche  $+$  = cariche  $-$ ):

$$n + N_A^- = p + N_D^+$$

Qst relazione è chiamata condizione di neutralità locale. Cioè il materiale non emette radiazioni perché è in stato di equilibrio

oss: Se  $N_D^+ = N_A^-$  vediamo che la carica compensata netta  $N^+ = N_D^+ - N_A^-$  si annulla ( $N^+ = 0$ ). In qst stato torniamo alle condizioni del semiconduttore intrinseco  $n = p \Rightarrow n_i^2 = np$ , cioè come se il materiale non fosse stato drogato. Infatti i due drogaggi (qll di tipo n e qll di tipo p si compensano).

Il prodotto delle due popolazioni ( $n$  e  $p$ ) dev'essere ang uguale sempre a qll intrinseco ( $n_i^2$ ). Quindi quando drogiamo un materiale per renderlo di tipo n aumenterò gli elettroni liberi ma diminuiranno le lacune e viceversa. Infatti  $n_i^2 = np$ . Per far sì che  $n_i^2$  sia uguale se aumento un termine nel prodotto l'altro deve diminuire proporzionalmente. Le cariche mobili dello stesso tipo del drogaggio vengono dette portatori di maggioranza, le altre portatori di minoranza.

→ Quando se il campione è drogato n ( $N^+ > 0$ ) si ha:

$$\boxed{n = N^+ \quad ; \quad p = \frac{n_i^2}{N^+}} \quad \text{se } \underline{n_i \ll N^+}$$

→ Se il campione è drogato p ( $N^+ < 0$ ) si ha:

$$\boxed{p = |N^+| \quad ; \quad n = \frac{n_i^2}{|N^+|}} \quad \text{se } \underline{n_i \ll |N^+|}$$

nota: Valori validi per semiconduttori omogenei e non degeneri.

Fino ad ora il nostro semiconduttore è all'equilibrio termodinamico come spiegato prima.

Ora vedremo quando non lo è.



$$\boxed{v_n = -\mu_n E} \quad ; \quad \boxed{v_p = \mu_p E}$$

dove:  $v_n$  è la velocità (media) degli elli liberi

$\mu_n$  è la mobilità degli elli liberi

$v_p$  è la velocità (media) delle lacune

$\mu_p$  è la mobilità delle lacune

$$(\mu_n \neq \mu_p) > \phi$$

$$(\mu_n > \mu_p)$$

Le cariche negative si muovono in direzione opposta ad  $E$ , mentre le cariche positive nella stessa direzione di  $E$ .

oss: Il parametro della mobilità sembra un concetto semplice ma in realtà è molto complesso. "centro" a qst parametro è compresa la relazione delle particelle rispetto agli altri atomi che compongono la struttura cristallina ed altre relazioni complesse che sono state formulate per la "costruzione" della teoria dello studio dei solidi.

In generale il parametro  $\mu$  non è costante, ma varia nel tempo. presenza della nota

$\mu$  ha valore costante solo per valori di  $E$  molto piccoli. ( $v = \mu E$ )

Il valore di  $\mu$  per  $E \rightarrow \phi$  è detto mobilità di basso campo ( $\mu_0$ )

Per campi molto elevati la mobilità tende alla saturazione detta costante di velocità di saturazione (nell'ordine dei  $10^7$  cm/s) (Si, Ge)

oss: In alcuni materiali la mobilità può essere differenziale ( $\mu_d$ ) e presentare mobilità differenziale  $\mu_d = \frac{d|\mu|}{dE}$  negativa

(Soprattutto a RF dove non si usa più il Si ma GeAs)

DIPENDENZE PER LA MOBILITÀ  $\mu$

INTENSITÀ  $E$

DROGGAGGIO (CIOÈ PRESENZA DI IMPURITÀ NEL MATERIALE)

↳ RIDUZIONE DELLA MOBILITÀ

TEMPERATURA

Allo stesso modo  $J = I/A = \sigma E$

$$J_{(p)} = \frac{I_{(p)}}{A} = \frac{q p \mu_p E}{A} = q p \mu_p E = \sigma E \quad , \quad \text{da cui}$$

$$\sigma_p = q p \mu_p$$

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA dovuta  
alle lacune di mobilità  $\mu_p$

- Se abbiamo una situazione in cui  $n$  e  $p$  sono trascurabili allora semplicemente lo siamo delle qntà appena calcolate:

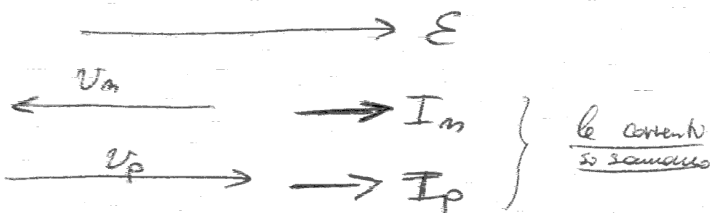
$$J_{tr} = J_{n,tr} + J_{p,tr} = q n \mu_n E + q p \mu_p E \quad , \quad \text{da cui:}$$

$$\sigma = q n \mu_n + q p \mu_p$$

$$(\sigma = \sigma_n + \sigma_p)$$

le due correnti  
si sommano.

Nota: Per capire meglio perché le correnti si sommano:



La velocità degli elettroni è opposta al c.e.  $E$  perché hanno carica negativa, quindi  $v_n$  sarà negativa. Per il calcolo della corrente però devo moltiplicare qst 2 quantità e siccome l'elt ha carica negativa ( $-q$ ) il segno della corrente sarà positivo.

$$I_n = -q n A (-v_n) = -q n A (-\mu_n E) = +q n A \mu_n E$$

Per la lacuna invece non c'è alcuna qntà negativa. Infatti essendo di carica positiva ( $+q$ ) la velocità sarà concorde con il  $E$  e quindi positiva.